Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

HK32F39A xCxDxE 数据手册

Rev1.1.0



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

Contents

Η	listory	1
1	说明	2
2	产品综述	3
	2.1 产品简介	3
	2.2 产品特点	
	2.3 器件一览表	8
	2.4 订货代码	9
3	功能介绍	10
	3.1 结构框图	10
	3.2 存储器映射	
	3.2.1 Flash 特性	
	3.2.2 Flash Option Word 设置	
	3.2.3 内置 RAM	
	3.2.4 内置 CCM RAM	
	3.3 协处理器	
	3.4 Cache	
	3.5 CRC 计算单元	
	3.6 FSMC	
	3.7 NVIC	
	3.8 EXTI	
	3.9 复位	
	3.9.1 系统复位	
	3.9.2 电源复位	
	3.9.3 备份域复位	
	3.10 时钟	
	3.10.1 时钟源	
	3.10.2 时钟树	
	3.11 Boot 模式 3.12 供电方案	
	3.13 电源监控器	
	3.14 低功耗模式	
	3.15 DMA	
	3.16 RTC 和 BKP	
	3.16.1 RTC	
	3.16.2 BKP	
	3.17 独立看门狗	
	3.18 窗口看门狗	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

	3.19 System Tick 定时器	27
	3.20 基本定时器	27
	3.21 通用定时器	27
	3.22 高级定时器	27
	3.23 IIC 总线	28
	3.24 USART	28
	3.25 SPI	28
	3.26 SDIO	29
	3.27 CAN	29
	3.28 USB	29
	3.29 GPIO	29
	3.30 ADC	29
	3.31 DAC	30
	3.32 模拟比较器	30
	3.33 温度传感器	30
	3.34 DCMI 数字相机接口	31
	3.35 SAI 语音接口	31
	3.36 QSPI Flash 接口	31
	3.37 TFT LCD 接口	31
	3.38 TRNG 模块	31
	3.39 AES 模块	32
	3.40 HASH 模块	32
	3.41 96Bit-UID	32
	3.42 调试及跟踪接口	33
4	电气性能指标	34
	4.1 最大绝对额定值	34
	4.1.1 极限电压特性	
	4.1.2 极限电流特性	
	4.1.3 极限温度特性	
	4.2 工作参数	
	4.2.1 推荐工作条件	
	4.2.2 复位和低压检测	
	4.2.3 内部参考电压	
	4.2.4 工作电流特性	
	4.2.5 HSE 时钟特性	
	4.2.6 LSE 时钟特性	
	4.2.7 HSI 时钟特性	
	4.2.8 LSI 时钟特性	
	4.2.9 PLL 特性	
	4.2.10 GPIO 输入时钟	
	4.2.11 Flash 存储器特性	
	4.2.12 IO 输入引脚特性	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

	shenzhen Hangshan emp Teemhology Bevelopmen	г сол, шта.
	4.2.13 IO 输出引脚特性	40
	4.2.14 NRST 复位管脚特性	41
	4.2.15 TIM 计数器特性	41
	4.2.16 ADC 特性	42
	4.2.17 DAC 特性	43
	4.2.18 温度传感器特性	44
5	典型电路	45
	5.1 电源供电	45
	5.2 其他参考电路	45
6	管脚定义	46
7	功能说明	64
	7.1 OSC_IN/OSC_OUT 复用功能说明	64
	7.2 FSMC 复用功能说明	65
	7.3 TFT 复用功能说明	65
	7.4 USART 复用功能说明	65
8	封装参数	66
	8.1 LQFP64 10X10mm,0.5mm pitch	66
	8.2 LQFP64 推荐封装	
	8.3 LQFP100 14X14mm,0.5mm pitch	68
	8.4 LQFP100 推荐封装	69
9	缩略语	70
10) 重要提示	71



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

History

Version	Date	Description		
1.0.0	2019/07/23	初始版本		
1.0.1	2019/08/05	修改 说明一节中 关于公司名称的描述		
		文档页眉 增加深圳航顺公司 logo		
		文档页脚 增加页码和公司官网链接		
		目录更新 包含页码		
1.0.2	2019/08/23	增加 7.1 节		
1.0.3	2019/09/6	修改 3.2 memory map 图		
1.0.4	2019/09/23	增加 3.7 NVIC SAI 中断向量		
1.0.5	2019/10/23	修改结构框图		
1.0.6	2019/11/07	修改 Pinout 施密特说明		
1.0.7	2019/12/16	修改 3.10.2 时钟树图		
1.0.8	2019/12/23	修改 Pinout 81/82 Notes		
1.0.9	2020/4/8	增加工作电流表		
1.1.0	2020/8/19	修改管脚定义中的 FSMC 部分		
		更新公司 LOGO		

http://www.hsxp-hk.com

1



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

1 说明

本文档为 HK32F39A RCT6/HK32F39ARDT6/HK32F39ARET6、

HK32F39AVCT6/HK32F39AVDT6/HK32F39AVET6 芯片数据手册。HK32F39A 系列芯片是深圳市航顺芯片技术研发有限公司开发的低功耗 MCU 芯片,请联系深圳市航顺芯片技术研发有限公司提供更多相关文档。

http://www.hsxp-hk.com

2



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

2 产品综述

2.1 产品简介

HK32F39A 系列使用高性能的 ARM® CortexTM-M3 内核,最高工作频率 120MHz, 带有一级 1KB 指令 Cache 缓存。HK32F39A 内置了航顺自主研发的协处理器,可实现绝大部分 ARM® CortexTM-M4 内核支持的算术指令,包括 32 位单精度浮点运算;此外,协处理器支持多种自定义的 32 位及 64 位算术运算。

HK32F39A 内置了大容量存储器: 527KB FLASH、97KB SRAM 和 512B VBAT 备份 SRAM。此外,可通过 FSMC 模块外挂最多 1GB 容量的 NOR/PSRAM/NAND/PC Card 存储器,其中有 256MB 的空间可以存放指令,并且可以被片内 1KB 指令 Cache 缓存。可通过 QSPI 模块外挂 256MB 容量的 NOR FLASH 存储器,可存放指令,并且可以被片内 1KB 指令 Cache 缓存。

HK32F39A 内置了 AES、HASH 和 TRNG 真随机数发生器;用于数据加解密及数字签名等应用;同时内置的 CRC 模块提供了数据完整性的检查能力。HK32F39A 内置了指令加、解密功能,放在片内存储器和外挂存储器的指令可实现千芯千面的密文存储。

HK32F39A 内置了丰富的通信接口满足多种通信应用场景: 6 路 USART、3 路 SPI (支持 I2S 协议)、1 路 SDIO、2 路 I2C、2 路 CAN 2.0 A/B 和 1 路 FS USB device。

HK32F39A 通过内置的 DCMI 数字照相机接口、四路 TFT 接口和两个 DMA 模块 (共 12 路 DMA 通道)可实现数字图像视频从捕获、运算处理到显示的单芯片解决方案。

HK32F39A 内置了串行音频接口 SAI,支持当前大多数的音频接口协议。支持的协议有: I2S、LSB/MSB-justified、PCM/DSP、TDM、AC'97、SPDIF 发送端和 PDM 接收端。SAI 接口包含了两个独立的音频协议处理模块,每个模块有其独立的时钟单元和协议处理单元,用户可根据需要配置为:协同工作或独立工作、主接口或从接口、接收端或发送端。(HK32F39A 工程样片不提供 SAI 接口)

HK32F39A 内置 2 个高级 16-bit PWM 计时器 (共 8 路 PWM 输出,其中 6 路带死 区互补输出),4 个通用 16-bit PWM 计时器 (共 16 路 PWM 输出);2 个高级 PWM 计时器与内置的4 路 VC 电压比较器片内互连,可为客户节省电机方案中板级 VC 电压比较器及相关电路。

HK32F39A 提供独立的 VBAT 电池电源域,当 VDD 主电源掉电时,RTC 模块可在 VBAT 电源供电的情况下继续工作;另外,VBAT 电池电源域提供了 20B 的备份寄存器,及 512B 的备份 SRAM。(HK32F39A 工程样片不提供 512B 备份 SRAM)

HK32F39A 内置了丰富的模拟电路: 3 个 12-bit ADC (共 25 路模拟信号输入通道,其中 2 路弱驱动信号输入通道和 1 路 5V 高压信号输入通道)、2 个 12-bit DAC、1 个温度传感器、1 个 0.8V 内部参考电压源、1 个 LVD 低电压检测器、1 个 POR/PDR 上下电复位电路和 1 个 VBAT 电源电阻分压器(分压器输出在片内与 ADC 相连)。

HK32F39A 支持丰富的功耗模式;在最低功耗模式下,芯片的典型漏电电流小于100nA。HK32F39A 工作于-40°C 至+105°C 的温度范围,供电电压 1.8V 至 3.6V,可满足绝大部分应用环境条件的要求。完整的 HK32F39AxC、HK32F39AxD 和HK32F39AxE 系列产品包括从 64 脚至 100 脚的两种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

这些丰富的外设配置,使得 HK32F39A 微控制器适合于多种应用场景:

- 工业应用,可编程控制器、打印机、扫描仪
- HMI 人机音视频多媒体交互
- 图形显示设备
- 语音识别设备
- 广告显示设备
- 安全监控设备
- 电机驱动和调速控制
- 物联网低功耗传感器终端
- 无人机飞控、云台控制
- 玩具产品
- 家用电器
- 智能机器人
- 智能手表、运动手环

4



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

2.2 产品特点

- 工作电压范围
 - 双电源域: 主电源 VDD 1.8V ~ 3.6V、备份电池电源 VBAT 1.8V ~ 3.6V
 - 当主电源掉电时,RTC 模块可继续工作在 VBAT 电源下工作
 - 当主电源掉电时, VBAT 电源下提供 20Bytes 备份寄存器, 512Bytes 备份 RAM
- VDD 典型工作电流
 - Run 工作模式功耗:16mA@120MHz@3.3V(133.3uA/MHz)
 - Sleep 睡眠模式功耗:7mA@120MHz@3.3V(58.3uA/MHz),唤醒时间 8.3nS
 - Stop 停机模式功耗:30uA@3.3V(10uS 唤醒)
 - Standby 待机模式功耗:2uA@3.3V(150uS 唤醒)
 - Shutdown 关机功耗:100nA@3.3V(200uS 唤醒)
- VBAT 典型工作电流(VDD 掉电)
 - VBAT RTC 模式功耗:1uA@3.3V
 - VBAT 模式功耗:600nA@3.3V (RTC 关闭, 20B 备份寄存器和 512B 备份 SRAM 保持)
- ARM Cortex-M3 Core
 - 最高时钟频率: 120MHz
 - 24 位 System Tick 计时器
 - 支持 CPU Event 信号输入至 MCU 引脚,实现与板级其它 SOC CPU 的联动

● 算术运算协处理器

- 实现绝大部分 ARM® CortexTM-M4 内核支持的算术指令
- 32 位单精度浮点运算
- 多种自定义的 32 位及 64 位算术运算
- DMA 控制器
 - 2 个独立 DMA 控制器 DMA1 和 DMA2
 - DMA1 提供 7 路通道
 - DMA2 提供 5 路通道
 - 支持 Timers、ADC、SPIs、I2Cs、USARTs 等多种外设触发
- 存储器
 - 527KByte 的 Flash 存储器,包括主区 Flash512KB,Information 空间 15KB。 CPU 主频不高于 24MHz 时,支持 0 等待总线周期,具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
 - 1KB CPU 指令 Cache 缓存
 - 最大 97KB 片内 SRAM(包括 65KByte SRAM 和 32Kbyte CCRAM)
 - FSMC 模块可外挂 1GB NOR/PSRAM/NAND/PC Card 存储器 (其中有 256MB 的空间可以存放指令,可被片内 Cache 缓存)



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

- QSPI 模块可外挂 256MB NOR FLASH 存储器 (可存放指令,可被片内 Cache 缓存)
- 内置指令加、解密功能,放在片内存储器和外挂存储器的指令可实现千芯千面 的密文存储

● 时钟

- 外部 HSE: 支持 4~32MHz 晶振, 典型 8MHz 晶振
- 外部 LSE: 32.768KHz 晶振
- 芯片上的 HSI 时钟: 56MHz/8MHz
- 芯片上的 LSI 时钟: 40KHz
- PLL 时钟

● 复位

- 外部管脚复位
- 电源上电复位
- 软件复位
- 看门狗(IWDG 和 WWDG)定时器复位
- 低功耗模式复位

● 安全加密

- TRNG 真随机数发生器
- 128/192/256 位 AES
- HASH(SHA-256)
- CRC32

● 数据通讯接口

- 6 路 USART
- 3 路 SPI (支持 I2S 协议)
- 2路 I2C
- 1路 SDIO
- 2 路 CAN 2.0 A/B
- 1 路 FS USB device

● 音视频数据接口

- 1个 DCMI 数字照相机接口
- 4 个 TFT display 接口
- 1 个 SAI 串行音频接口(包含了两个独立的音频协议处理模块)
- 定时器及 PWM 发生器
 - 高级定时器: TIM1/TIM8 (共8路 PWM 输出,其中6路带死区互补输出)
 - 通用定时器: TIM2/3/4/5 (共 16 路 PWM 输出)
 - 基本定时器: TIM6/7(支持 CPU 中断、DMA 请求和 DAC 转换触发)
- 低电压检测 (PVD)



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

- 8级检测电压门限可调
- 上升沿和下降沿可配置
- 片内模拟外设
 - 3 个 12-bit 3Msps ADC (共 25 路模拟信号输入通道; 其中 2 路弱驱动信号输入通道和 1 路 5V 高压信号输入通道); 支持双 ADC dual-mode 模式,采样率最高 6Msps
 - 2 个 12-bit DAC
 - 1个温度传感器
 - 1 个 0.8V 内部参考电压源
 - 1 个 VBAT 电源电阻分压器(分压器输出在片内与 ADC 相连,实现 VBAT 电源电压监控)
 - 4 路 VC 电压比较器(与片内两个高级 PWM 计时器互连,可为客户节省电机 方案中板级 VC 电压比较器及相关电路)

● ID 标识

- 每颗 HK32F39A 芯片提供一个唯一的 96-bit ID 标识
- 航顺品牌识别 ID
- 调试及跟踪接口
 - SW-DP 两线调试端口
 - JTAG 五线调试端口
 - ARM DWT、FPB、ITM、TPIU 调试追踪模块
 - 单线异步跟踪数据输出接口(TRACESWO)
 - 四线同步跟踪数据输出接口(TRACEDO[3:0], TRACECK)
 - 自定义 DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)

● 通用输入输出 IO

- 64 引脚产品有 51 个 GPIO 引脚, 100 引脚产品有 80 个 GPIO 引脚
- 所有 GPIO 引脚可配置为外部中断输入
- 内置可开关上、下拉电阻
- 支持 Open-Drain 开漏输出
- 支持 Schmitt 迟滞输入
- 输出驱动能力超高、高、中、低四档可选
- 提供最高 20mA 驱动电流
- RTC 时钟计数器,配合软件记录年月日时分秒
- 可靠性
 - 通过 HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU 等级测试
- 工作温度范围: -40°C ~ 105°C



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

2.3 器件一览表

Part	HK32F39A	HK32F39A	HK32F39A	HK32F39A	HK32F39A	HK32F39A
	RCT6	RDT6	RET6	VCT6	VDT6	VET6
CPU 工作 频率	120MHz					
Flash	256KBytes	384KBytes	512KBytes	256KBytes	384KBytes	512KBytes
SRAM			65K	bytes		
CCRAM			32K	bytes		
协处理器				1		
Cache			1Kb	ytes		
DMA			,	2		
AES				1		
HASH				1		
TRNG				1		
CRC32				1		
FSMC	N/A	N/A	N/A	1	1	1
TFT	N/A	N/A	N/A	1	1	1
QSPI	1	1	1	1	1	1
DCMI	1	1	1	1	1	1
SDIO	1	1	1	1	1	1
I2C	2	2	2	2	2	2
USB	1	1	1	1	1	1
CAN	2	2	2	2	2	2
USART	6	6	6	6	6	6
SPI/I2S	3	3	3	3	3	3
高级 PWM 定时器	2	2	2	2	2	2
通用 PWM 定时器	4	4	4	4	4	4
基本定时器	2	2	2	2	2	2
GPIO	51			80		
IWDG				1		
WWDG	1					
96bit 1						
unique ID						
PVD	1					
ADC	3					
DAC		2				
Temp				1		
Sensor						



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

Volt	4		
Comparator			
工作电压	VBAT: 1	1.8~3.6V VDD: 1.8~3.6V	
工作温度		−40 to +105 °C	
封装	LQFP64	LQFP100	

2.4 订货代码

具体型号	包装	最小包数量
HK32F39ARCT6	卷带或 Tray 盘	
HK32F39ARDT6	卷带或 Tray 盘	
HK32F39ARET6	卷带或 Tray 盘	
HK32F39AVCT6	卷带或 Tray 盘	
HK32F39AVDT6	卷带或 Tray 盘	
HK32F39AVET6	卷带或 Tray 盘	

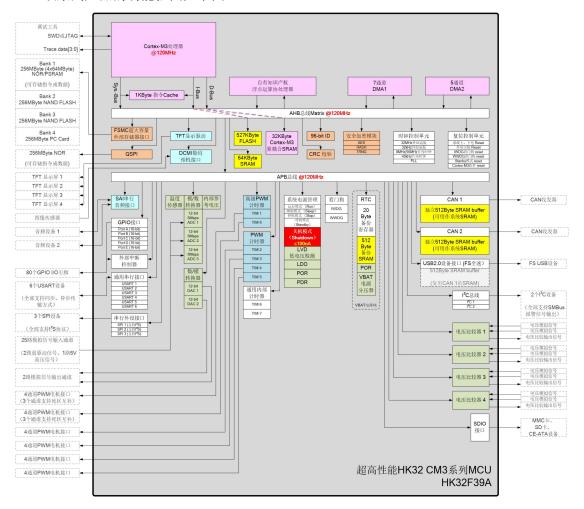
Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3 功能介绍

3.1 结构框图

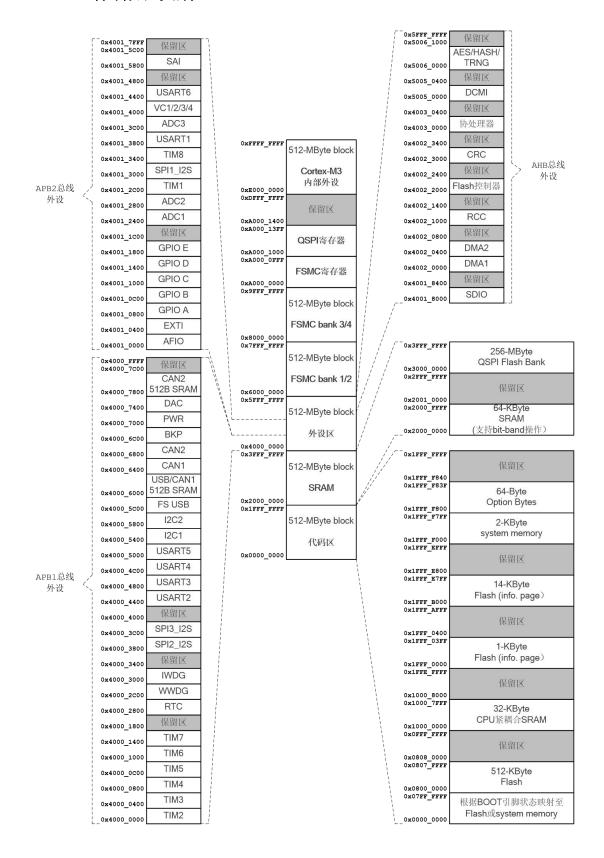
ARM 的 Cortex™-M3 处理器是最新一代的嵌入式 32 位 RISC 处理器,它是一个低成本高性能、超低功耗的 MCU 平台,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。 HK32F39A 系列产品拥有内置的 Cortex™-M3 核心,因此它与所有的 ARM 工具和软件兼容。

该系列产品的功能框图如下图:



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.2 存储器映射





Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.2.1 Flash 特性

HK32F39A 内部集成高达 527KByte 的闪存存储器,用于存放程序和数据。内置 Flash 包括三部分: 主区 512Kbytes; Information 区: 15Kbytes。

- Flash 数据位宽: 128 位; 页大小: 2Kbytes; 扇区大小: 1Kbytes。
- Flash 访问位宽:支持半字、字、2字和4字编程; 128位读。
- 支持 Flash 读/写保护访问控制。
- 集成预取指令 buffer 和数据 buffer。

HK32F39A 集成 Flash 加解密模块,支持 Flash 指令自动加解密,保护片内软件知识产权。

操作时间	读操作	擦除和编程操作
	当 HCLK<= 24MHz, 0 时钟周期等待; 当 24MHz <hclk<= 1="" 48mhz,="" 时钟周期等待<br="">HCLK 频率每增加 24MHz,等待周期数加 1。</hclk<=>	编程操作:约 42us(半字、字、2 字和4 字编程的时间相同) 擦除操作: 扇区擦除:约 3.7ms 页擦除:约 7.45ms 全片擦除:约 9ms
操作电压	2.0V~3.6V	
操作电流	编程操作:约 6mA 擦除操作:	约 2.2mA
使用寿命	支持 1 千次擦除和编写	

3.2.2 Flash Option Word 设置

Flash Option Word 结构如下表:

地址	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
0x1fff_f800	nUSER	USER	nRDP	RDP
0x1fff_f804	nDATA1	DATA1	nDATA0	DATA0
0x1fff_f808	nWRP1	WRP1	nWRP0	WRP0
0x1fff_f80c	nWRP3	WRP3	nWRP2	WRP2
0x1fff_f810~0x1fff_f81f	Reserved			
0x1fff_f820	ENCRY_CFG[31:0]			
0x1fff_f824		DECRY_	CFG[31:0]	
0x1fff_f828		UKEY	/ [31:0]	
0x1fff_f82c		UKEY	[63:32]	
0x1fff_f830	Rese	rved	IWDG_RL	_IV[11:0]
0x1fff_f834	IWDG_INI_KEY[31:0]			
0x1fff_f838	LSI_LP_CTL[31:0]			
0x1fff_f83c		DBG_CLK	_CTL[31:0]	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

HK32F39A 增加了如下 Option Word。

- ENCRY_CFG[31:0]: 如果存储的值为 0x1357_eca8,使能片内 Flash 数据加密。在使能加密后,再往 Flash 编程时,Flash 上存储的是加密后的密文。
- DECRY_CFG[31:0]: 如果存储的值为 0x2468_db97, 使能片内 Flash 数据解密。在使能解密后,会把从 Flash 读出的数据自动解密后再返给 CPU。
- UKEY[63:0]: 存储 Flash 加解密的秘钥,有用户自己配置。当 0x1fff_f828 和 0x1fff_f82C 的值不为全ff时,如果软件读 0x1fff_f828 和 0x1fff_f82C 地址,返回的值为 0xaaaa_aaaa。
- IWDG_RL_IV[11:0]:存储 IWDG_RLR 寄存器的初始值,当 IWDG 配置为 hardware watchdog 时,可以配置 IWDG_RL_IV[11:0]来设计 IWDG 的复位时间间隔。
- IWDG_INI_KEY[31:0]: 决定 IWDG_RL_IV 是否生效, 当 IWDG_INI_KEY[31:0]为 0xa5a5 5b1e 时, IWDG RL IV 配置有效, 否则无效。
- LSI_LP_CTL[31:0]:存储的值为 0x369c_f0f0 时,MCU 进入 STOP 或者 STANDBY mode 后,LSI 可以根据 LSION 的设置关掉 LSI;在 MCU 唤醒后,LSI 恢复成进模式之前的状态。如果不配置 LSI_LP_CTL,则如果在使能 IWDG 后再进入 STOP 或者 STANDBY mode,系统会被 IWDG 周期唤醒。用户可以通过配置 LSI_LP_CTL 来决定在使能 IWDG 后再进入 STOP 或者 STANDBY mode 时,是否需要被 IWDG 周期唤醒。
- DBG_CLK_CTL: 当存储的值为 0x1234_bcde 时 关闭 CPU 内部 Debug 时钟,否则 保持 Debug 时钟打开。

3.2.3 内置 RAM

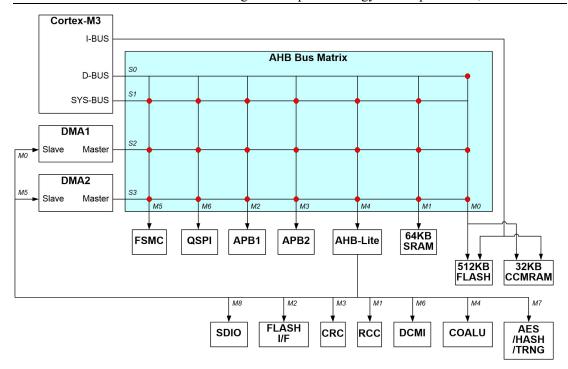
内部集成多达 64KByte SRAM, CPU 能以零等待周期进行快速读写访问,能够满足大多数应用的需求。支持字、半字和字节读写访问。

3.2.4 内置 CCM RAM

内部集成多达 32KByte 内核耦合存储器(CCM) SRAM,逻辑地址空间: 0x10000000~0x10007fff。支持支持字、半字和字节读写访问。CCM RAM 可以被 I-BUS、D-BUS、DMA1 和 DMA2 访问。总线矩阵如下图:



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.



3.3 协处理器

HK32F39A 内置了航顺自主研发的协处理器,可实现绝大部分 ARM® Cortex™-M4 内核支持的算术指令,包括 32 位单精度浮点运算;此外,协处理器支持多种自定义的 32 位及 64 位算术运算,提高芯片的运算能力,使芯片适合更多的运算场景。

定点运算:

- 64 位、32 位开方运算
- 64/32 位除法运算
- 饱和运算:
 - 乘累加饱和运算
 - 32 位饱和加减运算
 - SIMD 饱和加减运算
 - 数据饱和化
- SIMD 加减运算
- 加减取半运算
- 扩展加减运算
- 乘累加运算、SIMD 乘累加运算

浮点运算:

- 浮点加法运算
- 浮点减法运算
- 浮点乘法运算
- 浮点除法运算
- 浮点开方运算
- 浮点乘累加运算
- 浮点数定点数相互转换运算(包括 32 位定点数和浮点数相互转换、64 位定点数和浮点数相互转换)



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.4 Cache

HK32F39A 内部集成 1Kbytes 高速指令缓存。

- 使用 8 路组相联方式
- 使用最近最少使用替换方法,即每次缺失时,替换最久未使用的块
- 内置指令访问命中 Cache 次数计数器,方便用户统计程序 Cache 命中率
- 通过配置控制寄存器决定缓存三种不同的取指操作,同一时刻只能使能缓存其中一种取指访问。以下 3 种取指操作的数据可以被 Cache 缓存:
 - I-Bus 从片内 Flash 取指
 - SYS-Bus 通过 QSPI 从外部 Flash 取指
 - SYS-Bus 通过 FSMC 从外部 Flash 取指

3.5 CRC 计算单元

内部集成了一个独立的 CRC 硬件计算单元,为用户应用减轻负担,提供加速处理的能力。

CRC(循环冗余校验)计算单元使用一个固定的多项式发生器,从一个 32 位的数据字产生一个 CRC 码。 在众多的应用中,基于 CRC 的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。

3.6 FSMC

- 支持外部静态存储器,支持类型包括: SRAM、NOR Flash memory、PSRAM
- 支持两个 NAND Flash 接口,且支持最高 8K BYTE 数据的硬件 ECC 校验
- 支持一个 16 位 PC Card 接口;
- 支持 BURST 模式访问同步设备 (NOR Flash and PSRAM)
- 8 位或者 16 位宽的并行数据线;
- 每个外部存储器空间具有独立的片选控制和配置寄存器;
- 可编程的时序控制可以支持不同设备,如下
 - 可选的等待时间长度(最高 15 个周期)
 - 可选的访问切换时间(最高 15 个周期)
 - 可选的读使能和写使能延迟时间(最高 15 个周期)
 - 读操作和写操作各自独立的协议和时序控制,最大限度的支持不同种类的存储 器和时序要求
- 通过 32 位的 AHB 传输访问外部 16 位或 8 位存储器的连续 32 位空间;
- 一个数据长度的 buffer 用于对外部慢速存储器进行写操作时快速的释放系统总线。
- 外部存储器的异步等待控制逻辑
- 支持对 16 位外部存储器的写数据加密和读数据解密的功能;
- FSMC 也支持 Intel8080 模式和 Motorola6800 模式,可以灵活与各种 LCD 控制器 连接。

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.7 NVIC

内置嵌套的向量式中断控制器,该模块以最小的中断延迟提供灵活的中断管理功能。

- 紧耦合的 NVIC 能够达到低延迟的中断响应处理
- 中断向量入口地址直接进入内核
- 紧耦合的 NVIC 接口
- 允许中断的早期处理
- 处理晚到的较高优先级中断
- 支持中断尾部链接功能
- 自动保存处理器状态
- 中断返回时自动恢复,无需额外指令开销

HK32F39A 共有中断号为 0~69 的 70 个外部中断。其中 43~69 为 HK32F39A 新增外设的中断。

Posit	osit Priority		Acronym	Interrupt vectors	Description	Address
-	-	1	-		Reserved	0x0000_0000
-	-3	fixed	Reset		Reset	0x0000_0004
-	-2	fixed	NMI		Non maskable interrupt. The RCC Clock Security System (CSS) is linked to the NMI vector.	0x0000_0008
-	-1	fixed	HardFault		All class of fault	0x0000_000c
-	0	settable	MemManage		Memory management	0x0000_0010
-	1	settable	BusFault		Pre-fetch fault, memory access fault	0x0000_0014
-	2	settable	UsageFault		Undefined instruction or illegal state	0x0000_0018
-	-	-	-		Reserved	0x0000_001C - 0x0000_002B



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

-	3	settable	SVCall		System service call via SWI instruction	0x0000_002c
-	4	settable	Debug Monitor		Debug Monitor	0x0000_0030
-	-	-	-		Reserved	0x0000_0034
-	5	settable	PendSV		Pendable request for system service	0x0000_0038
-	6	settable	SysTick		System tick timer	0x0000_003c
0	7		WWDG	WWDG_IRQHandler	Window watchdog interrupt	0x0000_0040
1	8		PVD	PVD_IRQHandler	PVD through EXTI Line detection interrupt	0x0000_0044
2	9		TAMPER	TAMPER_IRQHandler	Tamper interrupt	0x0000_0048
3	10		RTC	RTC_IRQHandler	RTC global interrupt	0x0000_004c
4	11		FLASH	FLASH_IRQHandler	Flash global interrupt	0x0000_0050
5	12		RCC	RCC_IRQHandler	RCC global interrupt	0x0000_0054
6	13		EXTI0	EXTI0_IRQHandler	EXTI Line0 interrupt	0x0000_0058
7	14		EXTI1	EXTI1_IRQHandler	EXTI Line1 interrupt	0x0000_005c
8	15		EXTI2	EXTI2_IRQHandler	EXTI Line2 interrupt	0x0000_0060
9	16		EXTI3	EXTI3_IRQHandler	EXTI Line3 interrupt	0x0000_0064
10	17		EXTI4	EXTI4_IRQHandler	EXTI Line4 interrupt	0x0000_0068
11	18		DMA1_Channel1	DMA1_Channel1_IRQHandler	DMA1 Channel1 global interrupt	0x0000_006c
12	19		DMA1_Channel2	DMA1_Channel2_IRQHandler	DMA1 Channel2 global interrupt	0x0000_0070
13	20		DMA1_Channel3	DMA1_Channel3_IRQHandler	DMA1 Channel3 global interrupt	0x0000_0074
14	21		DMA1_Channel4	DMA1_Channel4_IRQHandler	DMA1 Channel4 global interrupt	0x0000_0078
15	22		DMA1_Channel5	DMA1_Channel5_IRQHandler	DMA1 Channel5 global interrupt	0x0000_007c
16	23		DMA1_Channel6	DMA1_Channel6_IRQHandler	DMA1 Channel6 global interrupt	0x0000_0080
17	24		DMA1_Channel7	DMA1_Channel7_IRQHandler	DMA1 Channel7 global interrupt	0x0000_0084
18	25		ADC1_2	ADC1_2_IRQHandler	ADC1 and ADC2 global interrupt	0x0000_0088



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

19	26	USB_HP_CAN_TX	USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler	USB high priority or CAN TX interrupts	0x0000_008c
20	27	USB_LP_CAN_RX0	USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler	USB low priority or CAN RX0 interrupts	0x0000_0090
21	28	CAN_RX1	CAN1_RX1_IRQHandler	CAN RX1 interrupt	0x0000_0094
22	29	CAN_SCE	CAN1_SCE_IRQHandler	CAN SCE interrupt	0x0000_0098
23	30	EXTI9_5	EXTI9_5_IRQHandler	EXTI Line[9:5] interrupts	0x0000_009c
24	31	TIM1_BRK_TIM9	TIM1_BRK_IRQHandler	TIM1 Break interrupt and TIM9 global interrupt	0x0000_00a0
25	32	TIM1_UP_TIM10	TIM1_UP_IRQHandler	TIM1 Update interrupt and TIM10 global interrupt	0x0000_00a4
26	33	TIM1_TRG_COM_TIM11	TIM1_TRG_COM_IRQHandler	TIM1 Trigger and Commutation interrupts and TIM11 global interrupt	0x0000_00a8
27	34	TIM1_CC	TIM1_CC_IRQHandler	TIM1 Capture Compare interrupt	0x0000_00ac
28	35	TIM2	TIM2_IRQHandler	TIM2 global interrupt	0x0000_00b0
29	36	TIM3	TIM3_IRQHandler	TIM3 global interrupt	0x0000_00b4
30	37	TIM4	TIM4_IRQHandler	TIM4 global interrupt	0x0000_00b8
31	38	I2C1_EV	I2C1_EV_IRQHandler	I2C1 event interrupt	0x0000_00bc
32	39	I2C1_ER	I2C1_ER_IRQHandler	I2C1 error interrupt	0x0000_00c0
33	40	I2C2_EV	I2C2_EV_IRQHandler	I2C2 event interrupt	0x0000_00c4
34	41	I2C2_ER	I2C2_ER_IRQHandler	I2C2 error interrupt	0x0000_00c8
35	42	SPI1	SPI1_IRQHandler	SPI1 global interrupt	0x0000_00cc
36	43	SPI2	SPI2_IRQHandler	SPI2 global interrupt	0x0000_00d0
37	44	USART1	USART1_IRQHandler	USART1 global interrupt	0x0000_00d4
38	45	USART2	USART2_IRQHandler	USART2 global interrupt	0x0000_00d8
39	46	USART3	USART3_IRQHandler	USART3 global interrupt	0x0000_00dc
40	47	EXTI15_10	EXTI15_10_IRQHandler	EXTI Line[15:10] interrupts	0x0000_00e0



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

41	48		RTCAlarm	RTCAlarm_IRQHandler	RTC alarm through EXTI line interrupt	0x0000_00e4	
42	40		USBWakeUp	LICDWalcal In IDOLlandian	USB wakeup from suspend through	0,0000 0008	
	49			USBWakeUp_IRQHandler	EXTI line interrupt	0x0000_00e8	
43	50		TIMO DDI/ TIM42	TIM8 BRK IRQHandler	TIM8 Break interrupt and TIM12 global	0x0000 00ec	
43	43 50		TIM8_BRK_TIM12	TIMO_DRK_IRQHAIIQIEI	interrupt	0x0000_00ec	
44	51		TIM8_UP_TIM13	TIM8_UP_IRQHandler	TIM8 Update interrupt and TIM13 global	0x0000_00f0	
44	31				interrupt	0x0000_0010	
45	52		TIM8 TRG COM TIM14	TIM8 TRG COM IRQHandler	TIM8 Trigger and Commutation	0x0000_00f4	
40	52		TIMO_TIXO_COM_TIMIT4	TIMO_TITO_COM_ITQTIANGE	interrupts and TIM14 global interrupt		
46	53		TIM8_CC	TIM8_CC_IRQHandler	TIM8 Capture Compare interrupt	0x0000_00f8	
47	54		ADC3	ADC3_IRQHandler	ADC3 global interrupt	0x0000_00fc	
48	55		FSMC	FSMC_IRQHandler	FSMC global interrupt	0x0000_0100	
49	56		SDIO	SDIO_IRQHandler	SDIO global interrupt	0x0000_0104	
50	57		TIM5	TIM5_IRQHandler	TIM5 global interrupt	0x0000_0108	
51	58		SPI3	SPI3_IRQHandler	SPI3 global interrupt	0x0000_010c	
52	59	settable	UART4	USART4_IRQHandler	USART4 global interrupt	0x0000_0110	
53	60	settable	UART5	USART5_IRQHandler	USART5 global interrupt	0x0000_0114	
54	61		TIM6	TIM6_IRQHandler	TIM6 global interrupt	0x0000_0118	
55	62		TIM7	TIM7_IRQHandler	TIM7 global interrupt	0x0000_011c	
56	63		DMA2_Channel1	DMA2_Channel1_IRQHandler	DMA2 Channel1 global interrupt	0x0000_0120	
57	64		DMA2_Channel2	DMA2_Channel2_IRQHandler	DMA2 Channel2 global interrupt	0x0000_0124	
58	65		DMA2_Channel3	DMA2_Channel3_IRQHandler	DMA2 Channel3 global interrupt	0x0000_0128	
59	66		DMA2_Channel4_5	DMA2_Channel4_5_IRQHandler	DMA2 Channel4 and DMA2 Channel5 global interrupts	0x0000_012c	
60	67	settable	QSPI	QSPI_IRQHandler	QSPI global interrupt	0x0000_0130	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

61	68	settable	DCMI	DCMI_IRQHandler	DCMI global interrupt	0x0000_0134
62	69	settable	COALU / AES	COALU_AES_IRQHandler	COALU global interrupt and AES global interrupt	0x0000_0138
63	70	settable	CAN2_TX	CAN2_TX_IRQHandler	CAN2 TX interrupts	0x0000_013c
64	71	settable	CAN2_RX0	CAN2_RX0_IRQHandler	CAN2 RX0 interrupts	0x0000_0140
65	72	settable	CAN2_RX1	CAN2_RX1_IRQHandler	CAN2 RX1 interrupt	0x0000_0144
66	73	settable	CAN2_SCE	CAN2_SCE_IRQHandler	CAN2 SCE interrupt	0x0000_0148
67	74	settable	HASH	HASH_RNG_IRQHandler	HASH global interrupt	0x0000_014c
68	75	settable	EXTI23_20	VC_IRQHandler	EXTI Line[23:20] (VC)interrupts	0x0000_0150
69	76	settable	USART6	USART6_IRQHandler	USART6 global interrupt	0x0000_0154
70	77	settable	SAI	SAI_IRQHandler	SAI global interrupt	0x0000_0158



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.8 **EXTI**

外部中断/事件控制器包含 26 个边沿检测器,用于产生中断/事件请求,其中 0-15 连接 IO。每个中断线都可以独立地配置它的触发事件(上升沿或下降沿或双边沿),并能够单独地被屏蔽。拥有一个挂起寄存器维持所有中断请求的状态。

- EXTI 16 连接 PVD 输出
- EXTI 17 连接 RTC 的 Alarm 事件
- EXTI 18 连接 USB 的 Wakeup 事件
- EXTI 20 连接 VC1 的输出
- EXTI 21 连接 VC2 的输出
- EXTI 22 连接 VC3 的输出
- EXTI 23 连接 VC4 的输出
- EXTI 24 连接 ADC1 的 AWD 事件
- EXTI 25 连接 ADC2 的 AWD 事件
- EXTI 26 连接 ADC3 的 AWD 事件

其中 24,25,26 作为内部事件没有 RTSR、FTSR、SWIER 和 PR 寄存器,只能在 STOPMODE 下采事件的上升沿产生 ERQ 和 IRQ 唤醒系统。

3.9 复位

HK32F39A 支持三种复位:系统复位、上电复位、备份域复位。

3.9.1 系统复位

除了时钟控制器的 RCC_CSR 寄存器中的复位标志位和备份区域中的寄存器以外,系统复位将复位所有寄存器至它们的复位状态。当发生以下任一事件时,产生一个系统复位:

- NRST 引脚上的低电平(外部复位)
- 窗口看门狗计数终止(WWDG 复位)
- 独立看门狗计数终止(IWDG 复位)
- 软件复位(SW 复位)
- 低功耗管理复位

可通过查看 RCC CSR 控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源。

软件复位	通过将 Cortex™-M3 中断应用和复位控制寄存器中的 SYSRESETREQ 位置'1',可实现软件复位。
低功耗 管理复位	在进入待机模式时产生低功耗管理复位 通过将用户选择字节中的 nRST_STDBY 位置'1'将使能该复位。这时,即使执行了进入待机模式的过程,系统将被复位而不是进入待机模式。
	在进入停止模式时产生低功耗管理复位 通过将用户选择字节中的 nRST_STOP 位置'1'将使能该复位。这时,即 使执行了进入停机模式的过程,系统将被复位而不是进入停机模式。

21



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

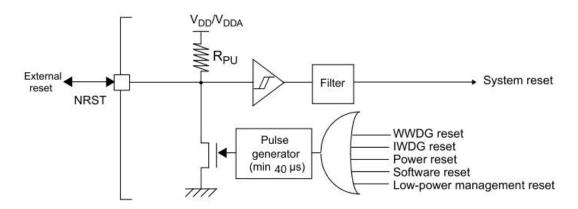
3.9.2 电源复位

当以下事件中之一发生时,产生电源复位:

- 上电/掉电复位(POR/PDR 复位)
- 从待机模式中返回

电源复位将复位除了备份区域外的所有寄存器。复位源将最终作用于 RESET 引脚,并在复位过程中保持低电平。复位入口矢量被固定在地址 0x0000 0004。

芯片内部的复位信号会在 NRST 引脚上输出,脉冲发生器保证每一个(外部或内部)复位源都能有至少 40 μs 的脉冲延时; 当 NRST 引脚被拉低产生外部复位时,它将产生复位脉冲。



3.9.3 备份域复位

备份区域拥有两个专门的复位,它们只影响备份区域。当以下事件中之一发生时,产生 备份区域复位。

- 软件复位,备份区域复位可由设置备份域控制寄存器 (RCC_BDCR)中的 BDRST 位产生。
- 在 VDD 和 VBAT 两者掉电的前提下, VDD 或 VBAT 上电将引发备份区域复位。

3.10 时钟

系统时钟的选择是在启动时进行,复位时内部 8MHz 的 RC 振荡器被选为默认的 CPU 时钟,随后可以选择外部的 4~32MHz 时钟。当外部时钟失效时,它将被隔离,同时产生相应的中断。同样,可以使用 PLL 倍频产生需要的时钟。

HK32F39A 也增加提供了 LSI、LSE、GPIO 输入作为时钟源,它为产品应用在低功耗、低成本设计上提供的方案。

HK32F39A 集成了 CSS(Clock smooth switch)电路,检测的 HSE 频率阈值可调。

3.10.1 时钟源

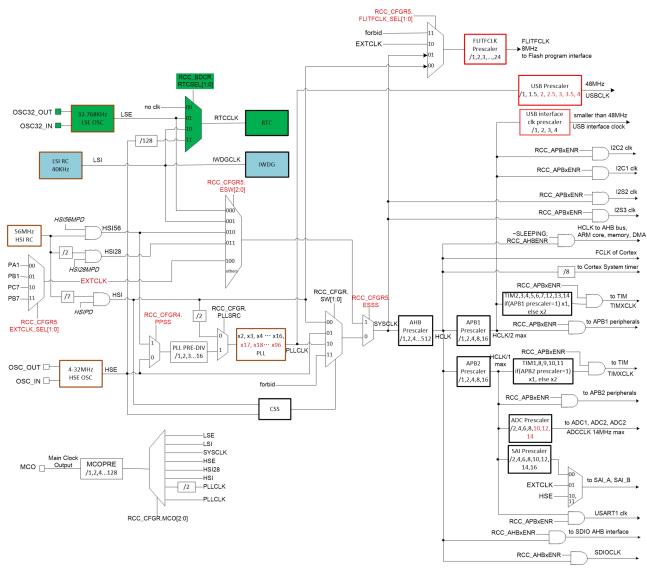
HSI 振荡器	输出频率 56MHz,可以分频为 28MHz,8MHz		
	精度: 全温范围±2%		
HSE 振荡器	支持 4~32MHz 晶体		
支持通过 OSC_IN 外部时钟输入,最高 64MHz			



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

PLL 时钟	输入时钟频率: 2~56MHz	
	输出时钟频率: 30~120MHz	
LSI 时钟	30~60KHz,typical 40KHz	
LSE 时钟	支持 32.768KHz 晶体	
	支持通过 OSC32_IN 外部时钟输入 32.768KHz	
GPIO 输入时钟	时钟 PA1、PB1、PC7、PB7 最高支持输入 64MHz	

3.10.2 时钟树



Notes:

- PLL 输入时钟: HSI8M/2、HSI56M/PREDIV 和 HSE/PREDIV 可选
- SYSCLK: HSI8M、HSI28M、HSI56M、HSE、PLL、LSI、LSE 和 GPIO 输入时 钟可选,默认为 HSI8M 时钟
- FLITFCLK: HSI8M、GPIO 输入时钟和 SYSCLK 可选



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.11 Boot 模式

在启动时,自举管脚被用于选择三种自举模式中的一种

- 从用户闪存自举
- 从系统存储器自举
- 从内部 SRAM 自举

自举加载程序存放于系统存储器中,可以通过 USART1 对闪存重新编程。

3.12 供电方案

- VDD = 2.0~3.6V: VDD 管脚为 I/O 管脚和内部 LDO 供电
- VDDA = 2.0~3.6V: 为 ADC、温度传感器模拟部分提供供电
- VBAT = 1.8~3.6V: 当关闭 VDD 时,内部电源切换电路将通过 VBAT 为 RTC、外部 32kHz 振荡器和后备寄存器供电

3.13 电源监控器

HK32F39A 内部集成了上电复位(POR)/掉电复位(PDR)电路,该电路始终处于工作状态,保证系统在供电超过 2V 时工作。当 VDD 低于 POR/PDR 阀值时,置器件于复位状态,而不必使用外部复位电路。

HK32F39A 还集成了一个可编程电压监测器(PVD),它监视 VDD 供电并与阀值 VPVD 比较,当 VDD 低于或高于阀值 VPVD 时将产生中断,中断处理程序可以发出警告信息或将微控制器转入安全模式。PVD 功能需要通过程序使能开启。

3.14 低功耗模式

HK32F39A 系列芯片支持多种功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。

● Sleep 睡眠模式

在睡眠模式,只有 CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒 CPU。

Stop 停机模式

在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,所有内部时钟被关闭,PLL、HSI 和 HSE 的 RC 振荡器被关闭。 可以通过任一配置成 EXTI 的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI 信号可以是 16 个外部 I/O口之一、PVD 的输出、RTC 闹钟或 USB 的唤醒信号。

● Standby 待机模式

在待机模式下可以达到最低的电能消耗。内部 LDO 被关闭,因此所有内部 1.5V 部分的供电被切断,PLL、HSI 和 HSE 的 RC 振荡器也被关闭,进入待机模式后,SRAM 和寄存器的内容将消失,但后备寄存器的内容仍然保留,待机电路仍工作。 从待机模式退出的条件是: NRST 上的外部复位信号、IWDG 复位、WKUP 管脚上的一个上升边沿或RTC 的闹钟到时。

● Shutdown 美机模式



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

工作模式	功耗指标	唤醒时间
RUN mode	动态功耗低至 156uA/MHz @3.3v	
SLEEP 睡眠模式	动态功耗 125uA/MHz @3.3v	唤醒时间 1 个机器时钟
STOP 停机模式	静态功耗 90uA @3.3v	最快 10uS 唤醒
STANDBY 待机模式	静态功耗 3uA @3.3v	150uS 唤醒时间
SHUTDOWN 关机模式	静态功耗可低至 0.1uA @3.3v	200uS 唤醒时间

低功耗模式讲入和唤醒方法:

低功耗模式进入和唤醒方法:				
工作模式	进入	唤醒		
SLEEP	设置: PWR_CR:LPDS = 0 PWR_CR:PDDS = 0 软件执行 WFI/WFE 指令进入	● 由任何一个普通 IRQ 中断事件唤醒,包括 SystemTicker		
STOP	设置: PWR_CR:LPDS = 0 或 1 PWR_CR:PDDS = 0 设置 CM3 系统控制寄存器的 SLEEPDEEP 位 软件执行 WFI/WFE 指令进入	 支持任何一个 EXTI 外部中 断线唤醒 支持定时 ADC 采样预唤醒. 当满足条件后真正唤醒. 支持 DAC 输出保持 		
STANDBY	设置: PWR_CR:LPDS =0 PWR_CR:PDDS =1 设置 CM3 系统控制寄存器的 SLEEPDEEP 位 软件执行 WFI/WFE 指令进入	● 支持 3 个可配置极性的外部 唤醒引脚以及 RTC ALARM 唤醒 支持 DAC 输出保持		
SHUTDOWN	设置: PWR_CR:LPDS =0 PWR_CR:PDDS =1 且 PWR_CSR2:SHDS = 1 设置 CM3 系统控制寄存器的 SLEEPDEEP 位 软件执行 WFI/WFE 指令进入	● 支持 3 个可配置极性的外部 唤醒引脚 ● 支持 RTC ALARM 唤醒		



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.15 DMA

灵活的 12 路通用 DMA(DMA1 上有 7 个通道, DMA2 上有 5 个通道)可以管理存储器到存储器、设备到存储器和存储器到设备的数据传输。2 个 DMA 控制器支持环形缓冲区的管理,避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断。

每个通道都有专门的硬件 DMA 请求逻辑,同时可以由软件触发每个通道;传输的长度、传输的源地址和目标地址都可以通过软件单独设置。DMA 可以用于主要的外设: SPI、I 2 C、USART、定时器 TIMx、SDIO 和 ADC 等。

3.16 RTC 和 BKP

RTC 和后备寄存器通过一个开关供电,在 VDD 有效时该开关选择 VDD 供电,否则由 VBAT 管脚供电。

3.16.1 RTC

实时时钟具有一组连续运行的计数器,可以通过适当的软件提供日历时钟功能,还具有闹钟中断和阶段性中断功能。

RTC 的驱动时钟可以是一个使用外部晶体的 32.768kHz 的振荡器、内部低功耗 RC 振荡器。内部低功耗 RC 振荡器的典型频率为 40kHz。为补偿天然晶体的偏差,可以通过输出一个 512Hz 的信号对 RTC 的时钟进行校准。RTC 具有一个 32 位的可编程计数器,使用比较寄存器可以进行长时间的测量。有一个 20 位的预分频器用于时基时钟,默认情况下时钟为 32.768kHz 时它将产生一个 1 秒长的时间基准。

HK3239A 增加一个 Wakeup Timer 用于周期性唤醒。

3.16.2 BKP

后备寄存器(Backup Register)可以用于保存用户应用数据。该寄存器不会被系统或电源复位源复位。当从待机模式唤醒时,也不会被复位。HK32F39A增加 BKP_DR0 备份域寄存器,包含 BKP DR0~10 共计 11 个备份域寄存器。

HK32F39A 不仅有备份寄存器,也增加了一个备份域存储器(Retention Memory),大小为 512Bytes。

3.17 独立看门狗

独立的看门狗是基于一个 12 位的递减计数器和一个 8 位的预分频器,它由一个内部独立的 40kHz 的 RC 振荡器提供时钟,因为这个 RC 振荡器独立于主时钟,所以它可运行于停机和待机模式。它可以被当成看门狗用于在发生问题时复位整个系统,或作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。通过选择字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。在调试模式,计数器可以被冻结。

设计 IWDG_WINR 寄存器,支持看门狗 window 窗口模式。IWDG 计数器复位初始值可由 FLASH option byte 设置



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.18 窗口看门狗

窗口看门狗内有一个7位的递减计数器,并可以设置成自由运行。它可以被当成看门狗用于在发生问题时复位整个系统。它由主时钟驱动,具有早期预警中断功能。在调试模式,计数器可以被冻结。

3.19 System Tick 定时器

这个定时器是专用于操作系统,也可当成一个标准的递减计数器。它具有下述特性。

- 24 位的递减计数器
- 重加载功能
- 当计数器为0时能产生一个可屏蔽中断
- 可编程时钟源

3.20 基本定时器

基本定时器是 TIM6 和 TIM7, 主要用于产生 DAC 触发信号,也可以作为通用的 16 位软件时基定时器。

3.21 通用定时器

每个通用定时器(TIM2/TIM3/TIM4/TIM5)都有一个 16 位的自动加载递加/递减计数器、一个 16 位的预分频器和 4 个独立的通道。每个通道都可用于输入捕获、输出比较、PWM和单脉冲模式输出,在最大的封装配置中可提供最多 16 个输入捕获、输出比较或 PWM通道。它们还能通过定时器链接功能与高级控制定时器共同工作,提供同步或事件链接功能。在调试模式下,计数器可以被冻结。

通用定时器也拥有 DAC 触发功能。

任一标准定时器都能用于产生 PWM 输出。每个定时器都有独立的 DMA 请求机制。HK32F39A 的 TIM2/TIM3/TIM4 也新增加了如下功能:

- CCER 寄存器新增 CCER[15]: CC4NP(输入双沿触发用)
- CCER 寄存器新增 CCER[11]: CC3NP (输入双沿触发用)
- CCER 寄存器新增 CCER[7]: CC2NP(输入双沿触发用)
- CCER 寄存器新增 CCER[3]: CC1NP(输入双沿触发用)
- 四路输入通道都新增下降沿触发,和双沿触发功能

3.22 高级定时器

高级控制定时器(TIM1 和 TIM8)可以被看成是分配到 6 个通道的三相 PWM 发生器,还可以被当成完整的通用定时器。四个独立的通道可以用于:

- 输入捕获
- 输出比较
- 产生 PWM(边缘或中心对齐模式)
- 单脉冲输出



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

● 互补 PWM 输出,具程序可控的死区插入功能

配置为 16 位标准定时器时,它与 TIMx 定时器具有相同的功能。配置为 16 位 PWM 发生器时,它具有全调制能力(0~100%)。 在调试模式下,计数器可以被冻结。很多功能都与标准的 TIM 定时器相同,内部结构也相同,因此高级控制定时器可以通过定时器链接功能与 TIM 定时器协同操作,提供同步或事件链接功能。

高级定时器也拥有 DAC 触发功能。

HK32F39A 的 TIM1 和 TIM8 也新增加了如下功能:

- CCER 寄存器新增 CCER[15]: CC4NP(输入双沿触发用)
- CR1 寄存器新增 CR1[15]: ETR_CLR_SEL (选择用外部引脚或是 VC4 比较器 输出来清除 PWM 输出)
- CR1 寄存器新增 CR1[14]: BRK_SEL (选择用外部引脚或是 VC1、2、3 比较器输出来实现 PWM 刹车)
- 四路输入通道都新增下降沿触发,和双沿触发功能

3.23 IIC 总线

多达 2 个 I2C 总线接口,能够工作于多主和从模式,支持标准和快速模式。I2C 接口支持 7 位或 10 位寻址,7 位从模式时支持双从地址寻址。内置了硬件 CRC 发生器/校验器。它们可以使用 DMA 操作,并支持 SMBus V2.0/PMBus 总线。

3.24 USART

内置了 6 个通用同步/异步收发器(USART1/USART2/USART3/

USART4/USART5/USART6)。这 6 个接口提供异步通信、支持红外线传输编解码、多处理器通信模式、单线半双工通信模式和 LIN 主/从功能。

USART1/6 接口通信速率可达 4.5MBit/s, USART2/3/4/5 接口通信速率可达 2.25MBit/s。 所有 USART 都具有硬件的 CTS 和 RTS 信号管理、与兼容 ISO7816 的智能卡模式和类 SPI 通信模式。

3.25 SPI

多达 3 个 SPI 接口,在从或主模式下,全双工和半双工的通信速率可达 18MBit/s。3 位的预分频器可产生 8 种主模式频率,可配置成每帧 8 位或 16 位。硬件的 CRC 产生/校验支持基本的 SD 卡和 MMC 模式。

所有的 SPI 接口都可以使用 DMA 操作。

3个 SPI 接口也可以工作在 I2S 模式下。3 个标准的 I2S 接口可以工作于主或从模式,这 3 个接口可以配置为 16 位或 32 位传输,亦可配置为输入或输出通道,支持音频采样 频率从 8kHz 到 48kHz 。当任一个 I2S 接口配置为主模式,它的主时钟可以以 256 倍采样频率输出给外部的 DAC 或 CODEC(解码器)。



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.26 SDIO

SD/SDIO/MMC主机接口可以支持 MMC卡系统规范4.2 版中的3个不同的数据总线模式: 1 位(默认)、4 位和 8 位。在 8 位模式下,该接口可以使数据传输速率达到48 MHz,该接口与兼容 SD 存储卡规范2.0 版。

SDIO 存储卡规范 2.0 版支持两种数据总线模式: 1位(默认)和 4位。

目前的芯片版本只能一次支持一个 SD/SDIO/MMC 4.2 版的卡,但可以同时支持多个 MMC 4.1 版或之前的卡。 除了 SD/SDIO/MMC,这个接口完全与 CE-ATA 数字协议版本 1.1 兼容。

3.27 CAN

HK32F39A 拥有 2 个独立的 CAN 接口。CAN 接口兼容规范 2.0A 和 2.0B (主动), 位速率高达 1MBit/s。它可以接收和发送 11 位标识符的标准帧, 也可以接收和发送 29 位标识符的扩展帧。具有 3 个发送邮箱和 2 个接收 FIFO, 3 级 14 个可调节的滤波器。

3.28 USB

内嵌一个兼容全速 USB 的设备控制器,遵循全速 USB 设备标准,端点可由软件配置,具有待机/恢复功能。USB 专用的 48MHz 时钟由内部主 PLL 直接产生。

3.29 **GPIO**

每个 GPIO 管脚都可以由软件配置成输出(推拉或开路)、输入(带或不带上拉或下拉)或其它的外设功能端口。多数 GPIO 管脚都与数字或模拟的外设共用。所有的 GPIO 管脚都有大电流通过能力。在需要的情况下,I/O 管脚的外设功能可以通过一个特定的操作锁定,以避免意外的写入 I/O 寄存器。

3.30 ADC

内嵌 3 个 12 位的模拟/数字转换器(ADC),每个 ADC 共用多达 16 个外部通道,可以实现单次或扫描转换。在扫描模式下,在选定的一组模拟输入上的转换自动进行。

ADC 接口上额外的逻辑功能包括:

- 同时采样和保持
- 交叉采样和保持
- 单次采样

ADC 可以使用 DMA 操作。模拟看门狗功能允许非常精准地监视一路、多路或所有选中的通道,当被监视的信号超出预置的阀值时,将产生中断。由标准定时器(TIMx)和高级控制定时器(TIM1)产生的事件,可以分别内部级联到 ADC 的开始触发和注入触发,应用程序能使 AD 转换与时钟同步。

HK32F39A 增加了 STOP 模式下的 AWD 唤醒功能:

系统在 STOP 模式下可以通过 RTC 计时发出信号到 ADC, ADC 采到该信号去唤醒 ADC 时钟,时钟准备好后触发 ADC 转换,根据 ADC 转换结果大小产生 AWD 事件,AWD 事



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

件输出到 EXTI 就可以唤醒系统。

3.31 DAC

HK32F39A 集成了两个 12 位带缓冲的 DAC 通道。它们可以用于转换 2 路数字信号成为 2 路模拟电压信号并输出。这项功能内部是通过集成的电阻串和反向的放大器实现。这个双数字接口支持下述功能:

- 两个 DAC 转换器: 各有一个输出通道
- 8 位或 12 位单调输出
- 12 位模式下的左右数据对齐
- 同步更新功能
- 产生噪声波
- 产生三角波
- 双 DAC 通道独立或同步转换
- 每个通道都可使用 DMA 功能
- 外部触发进行转换
- 输入参考电压 VREF+

HK32F39A 产品中有 8 个触发 DAC 转换的输入。DAC 通道可以由定时器的更新输出触发,更新输出也可连接到不同的 DMA 通道.

3.32 模拟比较器

HK32F39A 新增电压比较模块:

- 分别从8个IO上输入的4对电压到四个独立的电压比较器
- 4个比较器输出可以输出到 IO 或者作为计时器的事件输入
 - 1个比较器输出可以作为计时器 1 和 8 的 OCREF CLR 事件
 - 3 个比较器输出可以作为计时器 1 和 8 的 Break 事件
- 比较器输出可以作为 EXTI 的输入事件唤醒系统和产生中断
- 每个比较器可编程的迟滞电压:可选 0 和 30mv
- 每个比较器可编程的速度和功耗模式:
 - 低速超低功耗模式,功耗低至 3uA;
 - 低速低功耗模式,典型功耗 5uA;
 - 中速中等功耗模式,典型功耗 40uA;
 - 高速高功耗模式,典型功耗 100uA;
- 比较器输出高低极性可配

3.33 温度传感器

温度传感器产生一个随温度线性变化的电压。温度传感器在内部被连接到 ADC1_IN16 的输入通道上,用于将传感器的输出转换到数字数值。



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.34 DCMI 数字相机接口

DCMI 通过其同步并行数字接口,接收片外 CMOS 相机模块发送的高速图像视频数据。DCMI 具备以下特点:

- 支持多种数据格式: YCbCr4:2:2/RGB565 视频数据和 JPEG 压缩数据
- 并行接口位宽可配置为 8-、10-、12-或 14-bit
- 像素时钟和同步信号的极性可配
- 支持连续帧采样或单帧采样
- 支持图像自动裁剪
- 支持跳帧、跳行和跳像素点采样
- 8-word 深度数据接收 FIFO

3.35 SAI 语音接口

串行音频接口 SAI,支持当前大多数的音频接口协议。支持的协议有: I2S, LSB/MSB-justified, PCM/DSP, TDM, AC'97, SPDIF 发送端, PDM 接收端。

SAI 接口包含了两个独立的音频协议处理模块。每个模块有其独立的时钟单元和协议处理单元,用户可根据需要配置为:协同工作或独立工作,主接口或从接口,接收端或发送端。

支持的特征处理:双通道/单通道,μ_law/a_law 压缩解压等。

3.36 QSPI Flash 接口

QSPI 存储接口是一个针对单个,两个或者四个闪存存储的特殊通信接口。它可以工作在:

- 寄存器直接访问模式
- ◆ 外部闪存寄存器询问模式
- 内存映射模式

内存映射高达 256Mbytes 的外部闪存,支持 8,16 和 32 位访问。支持代码执行。操作码与帧格式完全可编程。通信可以是 SDR 或者 DDR。

3.37 TFT LCD 接口

TFT LCD 接口属于 FSMC 接口一部分,它可以直接驱动液晶屏。它和 FSMC 其它功能,同时只能选择一个。通过 FSMC 静态存储器接口可以驱动 4 个 TFT-LCD 面板(565 RGB格式,5位红色,6位绿色和5位蓝色),包括4个面板对应的4个行同步、4个列同步和4个数据有效指示信号。

3.38 TRNG 模块

TRNG 模块是一个以连续模拟噪声为基础的随机数发生器,提供一个 32 位的随机数。 RNG 时钟为 HSI 8MHz 分频时钟,刚使能 RNG 后,需要等待大约 1500 个时钟周期后再读取 RNG DR 寄存器。

31



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

- 提供由模拟量发生器产生的 32 位随机数
- 两个随机数的产生间隔为 32 个 8MHz 时钟
- 通过监视 RNG 熵来标识异常行为(产生稳定值,或产生稳定的值序列)
- 可被禁止以降低功耗

3.39 AES 模块

HK32F39A 集成了一个高级加解密单元,它完全符合 FIPS 197(Federal Information Processing Standards)。

- 支持 ECB\CBC\CTR 模式
- 支持 128 位、192 位和 256 位秘钥加密
- 加解密计算时间:
 - 128 位秘钥: 55 时钟周期
 - 192 位秘钥: 65 时钟周期
 - 256 位秘钥: 75 时钟周期
- 解密秘钥准备时间:
 - 128 位秘钥: 22 时钟周期
 - 192 位秘钥: 26 时钟周期
 - 256 位秘钥: 30 时钟周期
- 支持 AES 时钟随机化,和 TRNG 模块配合,随机化 AES 时钟
- 更方便的中断现场保护和中断现场恢复

3.40 HASH 模块

适用于数据验证的应用, 符合以下协议:

- FIPS PUB 180-2 (联邦信息处理标准出版物 180-2)
- 安全哈希标准规范(SHA-256)

SHA-256 快速运算处理系统中作为从设备挂着 AHB 总线上 32 位数据输入,输入数据长度可以是字、半字、字节和位为单位,只支持小端排列格式的数据。

自动转换小端排列格式的输入数据以适应采用大端排列格式的 SHA-256 运算标准自动 将最后一段输入数据补齐到 512 位(16x32 位)的摘要长度整个数据的摘要是通过连续 的信息块所计算的中间摘要不断更新计算出来的支持 DMA 的自动数据流控制。

3.41 96Bit-UID

96 位的产品唯一身份标识所提供的参考号码对任意一颗芯片,在任何情况下都是唯一的。用户在何种情况下,都不能修改这个身份标识。这个 96 位的产品唯一身份标识,按照用户不同的用法,可以以字节(8 位)为单位读取,也可以以半字(16 位)或者全字(32 位)读取。产品唯一的身份标识非常适合:

- 用来作为序列号(例如 USB 字符序列号或者其他的终端应用)
- 用来作为密码,在编写闪存时,将此唯一标识与软件加解密算法结合使用,提 高代码在闪存存储器内的安全性。
- 用来激活带安全机制的自举过程



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

3.42 调试及跟踪接口

内嵌 ARM 的 SWJ-DP 接口,这是一个结合了 JTAG 和串行单线调试的接口,可以实现串行单线调试接口或 JTAG 接口的连接。JTAG 的 TMS 和 TCK 信号分别与 SWDIO 和 SWCLK 共用管脚,TMS 脚上的一个特殊的信号序列用于在 JTAG-DP 和 SW-DP 间切换。

使用 ARM®的嵌入式跟踪微单元(ETM),HK32F39A 通过很少的 ETM 管脚连接到外部跟踪端口分析(TPA)设备,从 CPU 核心中以高速输出压缩的数据流,为开发人员提供了清晰的指令运行与数据流动的信息。TPA 设备可以通过 USB 或其它高速通道连接到调试主机,实时的指令和数据流向能够被调试主机上的调试软件记录下来,并按需要的格式显示出来。TPA 硬件可以从开发工具供应商处购得,并能与第三方的调试软件兼容。

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

4 电气性能指标

4.1 最大绝对额定值

最大额定值只是短时间的压力值。并且芯片在该值或者其他任何超出该推荐值的条件下工作是不可取的。超出下列最大额定值可能会给芯片造成永久性的损坏。长时间工作在最大额定值下可能影响芯片的可靠性。

4.1.1 极限电压特性

Table 4-1 极限电压特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
V_{DD} - V_{SS}	外部主供电电压(包含 V _{DDA} 和 V _{DD})	-0.5	4.0	3 7
$V_{\rm IN}$	引脚上的输入电压	VSS-0.3	VDD+4.0	V
$ \Delta VDDx $	不同供电引脚之间的电压差	-	50	V
V _{SSX} -V _{SS}	不同接地引脚之间的电压差	-	50	mV

4.1.2 极限电流特性

Table 4-2 极限电流特性

符号	描述	最大值	单位
I_{VDD}	经过 V _{DD} /V _{DDA} 电源线的总电流(供应电流) ¹	150	
I_{VSS}	经过 VSS 地线的总电流(流出电流) ¹	150	
т	任意 I/O 和控制引脚上的输出灌电流	25	A
I _{IO}	任意 I/O 和控制引脚上的输出拉电流	-25	mA
I _{INJ(PIN)} ²	引脚上的注入电流3	±5	
Σ I _{INJ(PIN)}	所有 I/O 和控制引脚上的总注入电流 4	±25	

Note1: 所有的电源(V_{DD}, V_{DDA})和地(V_{SS}, V_{SSA})引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

Note2: 反向注入电流会干扰器件的模拟性能。

Note3: 当 $V_{IN} > V_{DD}$ 时,有一个正向注入电流;当 $V_{IN} < V_{SS}$ 时,有一个反向注入电流,注入电流绝对不可以超过规定范围。

Note4: 当几个 I/O 口同时有注入电流时, ΣI_{INJ} 的最大值为正向注入电流与反向注入电流的即时绝对值之和。

4.1.3 极限温度特性

Table 4-3 极限温度特性

符号	描述	参数值	单位
T_{STG}	储存温度范围	- 45 to +150	٥ ر
Тл	最大结温度	125	

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

4.2 工作参数

4.2.1 推荐工作条件

Table 4-4 推荐工作条件

符号	描述	最小值	最大值	单位
f_{HCLK}	内部 AHB 时钟频率	0	120	
f_{PCLK1}	内部 APB1 时钟频率	0	60	MHz
f_{PCLK2}	内部 APB2 时钟频率	0	120	
V_{DD}	标准工作电压	2	3.6	V
$V_{DDA}{}^{1}$	模拟工作电压	2	3.6	V
V_{BAT}	备份部分工作电压	1.8	3.6	V
T	工作温度	-40	105	° C

Note1:建议使用相同的电源为 VDD 和 VDDA 供电,在上电和正常操作期间, VDD 和 VDDA 之间最多允许有 300mV 的差别。

4.2.2 复位和低压检测

Table 4-5 上电复位特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
T _{delay}	rstn 建立时间	-	-	40		us
V _{Threshold}	复位门限	-	-	1.75		V

Table 4-6 PVD 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		PLS[2:0]=000	2.183	2.188	2.196	
		PLS[2:0]=001	2.286	2.289	2.298	
	 可编程电压检测器的	PLS[2:0]=010	2.393	2.399	2.407	
	均無性电压位例留的 检测电平选择 (上升	PLS[2:0]=011	2.502	2.508	2.518	
	沿)	PLS[2:0]=100	2.621	2.629	2.639	
	1 II)	PLS[2:0]=101	2.726	2.733	2.745	
		PLS[2:0]=110	2.839	2.846	2.855	
V		PLS[2:0]=111	2.958	2.969	2.979	V
V_{PVD}		PLS[2:0]=000	2.116	2.119	2.125	V
		PLS[2:0]=001	2.208	2.211	2.220	
	 可编程电压检测器的	PLS[2:0]=010	2.305	2.310	2.320	
		PLS[2:0]=011	2.399	2.406	2.416	
	检测电平选择 (下降 沿)	PLS[2:0]=100	2.506	2.512	2.521	
		PLS[2:0]=101	2.596	2.602	2.613	
		PLS[2:0]=110	2.693	2.701	2.710	
		PLS[2:0]=111	2.798	2.805	2.817	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

4.2.3 内部参考电压

Table 4-7 参考电压特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VREFINT	内部参考电压	-40~105°C	0.74	0.8	0.811	V

4.2.4 工作电流特性

Table 4-8 工作电流特性

4-44	Ø W-		VDD	=3. 3V		T T .*4
模式	条件	−40°C	25°C	85°C	105°C	Unit
	HCLK=120MHz, FLASH_LATENCY	Cache	Cache	Cache	Cache	
	设置 4 个等待周期, APB 时钟	Enable:	Enable:	Enable:	Enable:	
	enable, cache	12. 18	20. 95	22. 31	23. 44	
	enable/disable	Cache	Cache	Cache	Cache	mA
		disable:	disable:	disable:	disable:	
		11. 2	19. 34	20. 71	21.82	
	HCLK=120MHz, FLASH_LATENCY	Cache	Cache	Cache	Cache	
	设置 4 个等待周期, APB 时钟	Enable:	Enable:	Enable:	Enable:	
	disable, cache	6. 71	11. 50	12. 74	13. 81	
	enable/disable	Cache	Cache	Cache	Cache	mA
		disable:	disable:	disable:	disable:	
		6. 1	10. 44	11. 66	12. 75	
	HCLK= HS E 8MHz,	Cache	Cache	Cache	Cache	
Run mode	FLASH_LATENCY 设置 0 等待周	Enable:	Enable:	Enable:	Enable:	
Kun mode	期,APB 时钟 enable, cache	1. 83	1. 98	3. 08	4. 1	
	enable/disable	Cache	Cache	Cache	Cache	mA
		disable:	disable:	disable:	disable:	
		3. 65	3. 91	5. 06	6. 12	
	HCLK= HS E 8MHz,	Cache	Cache	Cache	Cache	
	FLASH_LATENCY 设置 0 等待周	Enable:	Enable:	Enable:	Enable:	
	期,APB 时钟 disable, cache	1. 19	1. 36	2. 39	3. 41	
	enable/disable	Cache	Cache	Cache	Cache	mA
		disable:	disable:	disable:	disable:	
		1. 15	1. 25	2. 32	3. 36	
	HCLK=LSI 40KHz	0. 23	0. 31	1. 34	2. 33	mA
	HCLK=LSE 32.768KHz	0. 23	0.3	1. 35	2. 32	mA
	HCLK= 120MHz					
Sleep mode	APB 时钟 Enable	8. 52	14. 63	15. 92	17. 01	mA



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

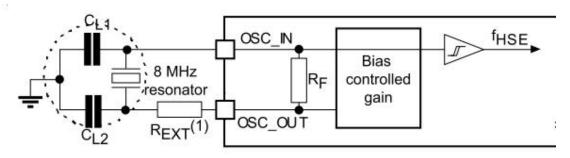
	HCLK= 120MHz APB 时钟 disable	3. 3	5. 65	6. 82	7. 85	mA
	HCLK=HSI 8MHz APB 时钟 Enable	1. 56	1. 69	2. 95	3. 72	mA
	HCLK=HSI 8MHz APB 时钟 disable	0.88	1. 01	2. 85	3. 04	mA
Gr. 1	LDO 全速工作状态 HSE/ HS I/LSE 关闭 IWDG OFF	202. 67	303	1322	2179	uA
Stop mode	LDO 低功耗状态 HSE/ HS I/LSE 关闭 IWDG 0FF	18. 38	89. 47	729	1374	uA
	LSI ON and IWDG on	2. 98	3. 87	16. 74	30. 29	uA
Standby mode	LSI ON and IWDG off	2. 96	3. 87	16. 68	30. 22	uA
	ALL of oscillator OFF	2. 35	3. 36	16. 16	29. 72	uA
	LSE ON And RTC RUN (BKPPDS = 0)	1.7	2. 67	11. 98	21. 87	uA
Shutdown Mode	LSE OFF And RTC OFF (BKPPDS = 1)	0.04	0. 09	0. 62	1. 60	uA
	LSE OFF And RTC STOP(BKPPDS = 0)	1. 31	2. 19	11. 41	21. 27	uA
VBAT	LSE/LSI ON And RTC RUN	1. 7	2. 67	11. 98	25. 86	uA
VDIII	LSE/LSI ON And RTC STOP	1. 31	2. 19	11. 41	21. 27	uA



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

4.2.5 HSE 时钟特性

HK32F39A集成了一个HSE负反馈晶体振荡电路,芯片外的起振推荐电路如下图:



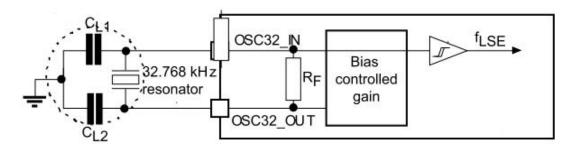
HK32F39A 也支持通过 OSC IN 直接输入一个时钟信号,时钟信号要求如下。

Table 4-9 外部高速时钟输入特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{HSE_ext}	时钟频率	-	1	8	25	MHz
V _{HSEH}	输入引脚高电平		$0.7V_{DD}$	-	V_{DD}	V
V_{HSEL}	输入引脚低电平		Vss	-	0.3V _{DD}	V
Tw _(HSE)	有效高/低电平时间		5	-	-	
Tr _(HSE)	上升/下降时间				20	ns
Tf(HSE)			-	-	20	
Cin _(HSE)	输入容抗	_	-	5	-	pF
DuCy _(HSE)	占空比	-	45	-	55	%

4.2.6 LSE 时钟特性

HK32F39A 集成了一个 LSE 负反馈晶体振荡电路,芯片外的起振推荐电路如下图:



HK32F39A 也支持通过 OSC32_IN 直接输入一个时钟信号,时钟信号要求如下。

Table 4-10 外部低速时钟输入特性

Symbol	Parameter	Condition s	Min	Тур	Max	Unit
F _{LSE_ext}	时钟频率	-	-	32.768	1000	kHz
V _{LSEH}	输入引脚高电平		0.7V _{DD}	-	V_{DD}	V
V _{LSEL}	输入引脚低电平		Vss	-	$0.3V_{DD}$	\ \
Tw _(LSE)	有效高/低电平时间		450	-	-	
Tr _(LSE)	上升/下降时间				50	Ns
Tf _(LSE)			-	-	50	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

Cin _(LSE)	输入容抗	-	-	5	-	pF
DuCy _(LSE)	占空比	-	30	-	70	%

4.2.7 HSI 时钟特性

Table 4-11 内部快速时钟特性

Symbol	Parameter	Conditions		Min	Тур	Max	Unit
$f_{ m HSI}$	时钟频率		-	-	8	-	MHz
DuCy _(HSI)	占空比		-	45	-	55	0/
		RCC_CR 寄	RCC_CR 寄存器校准后		-	1	%
ACC		工厂校准	T_A = -40 to 105 °C	-2	-	2.5	%
ACC _{HSI}	振荡器精度		$T_A = -40 \text{ to } 85 ^{\circ}\text{C}$	-1.5	-	2.2	%
			TA = 0 to 70 °C	-1.3	-	2	%
			TA = 25 °C	-1.1	-	1.8	%
T _{su(HSI)}	振荡器启动时间	$V_{SS} \leqslant V_{IN} \leqslant V_{DD}$		1	-	2	us
$I_{\text{DD(HSI)}}$	振荡器功耗			-	80	100	uA

4.2.8 LSI 时钟特性

Table 4-12 内部慢速时钟特性

Symbol	Parameter	Min	Тур	Max	Unit
f_{LSI}	时钟频率	30	40	60	kHz
t _{su(LSI)}	振荡器启动时间	-	-	85	us
I _{DD(LSI)}	振荡器功耗		0.65	1.2	uA

4.2.9 PLL 特性

Table 4-13 PLL 特性

Symbol	Davamatan		Value		
	Parameter	Min	Тур	Max	Unit
· c	输入时钟频率	1	8.0	25	MHz
$ m f_{PLL_IN}$	输入时钟占空比	40	-	60	%
$f_{\mathrm{PLL_OUT}}$	输出时钟频率	16	-	120	MHz
t _{LOCK}	锁相时间	-	-	200	us
Jitter	循环抖动	-	-	300	ps

4.2.10 GPIO 输入时钟

HK32F39A 支持从 PA1、PB1、PC7、PB7 输入时钟, 要求如下:

Table 4-14 GPIO 输入时钟特性

Symbol	Davameter		IInit		
	Parameter	Min	Тур	Max	Unit
Fort	输入时钟频率	1	8.0	64	MHz
Fext	输入时钟占空比	40	-	60	%
Jitter	循环抖动	-	-	300	ps



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

4.2.11 Flash 存储器特性

Table 4-15 Flash 存储器特性

Symbol	Parameter	Min	Тур	Max	Unit
T _{PROG}	单字节写入时间	6	-	7.5	μs
т	页擦除时间	4	-	5	ms
T_{ERASE}	整片擦除时间	30	-	40	ms
IDD _{PROG}	单字节写入电流	-	-	5	mA
IDD _{ERASE}	页/片擦除电流	-	-	2	mA
IDD	读电流@24MHz	-	2	3	mA
IDD _{READ}	读电流@1MHz	-	0.25	0.4	mA
N _{END}	擦写寿命	1			千次
t_{RET}	数据保存时间	20			年

4.2.12 IO 输入引脚特性

Table 4-16 IO 引脚直流特性

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
V_{IH}	输入高电平	VDD=3.3V	1.6			V
V _{IL}	输入低电平	VDD=3.3V			1.5	V
V _{IHhys}	输入高电平	VDD=3.3V	-			V
V _{ILhys}	输入低电平	VDD=3.3V			-	V
$V_{ m hys}$	施密特触发器电 压迟滞	VDD=3.3V		450mV@3.3V		mV
Ţ	於入泥中海	VDD=3.3V 0 <vin<3.3v< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td>uA</td></vin<3.3v<>			1	uA
I_{lkg}	输入漏电流	VDD=3.3V VIN=5V			1	uA
R _{PU}	上拉电阻	V _{IN} =V _{SS}		35		ΚΩ
R _{PD}	下拉电阻	V _{IN} =V _{DD}		35		ΚΩ
C _{IO}	I/O pin capacitance			5		pF

4.2.13 IO 输出引脚特性

Table 4-17 IO 引脚输出直流特性

Speed Mode	Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
	VOL	Output low level	C 50 E W 2W 2 CW	-	2	MHz
10	VOH	Output high level	C_L =50pF, V_{DD} =2V to 3.6V RLoad=5Kohm	-	125	ns
01	VOL	Output low level	C _L =50pF, V _{DD} =2V to 3.6V	-	2	MHz
	VOH	Output high level	RLoad=5Kohm	-	125	ns



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

Speed Mode	Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
	VOL	Output low level	C 50 E W 2W 2 CV	-	2	MHz
10	VOH	Output high level	C_L =50pF, V_{DD} =2V to 3.6V RLoad=5Kohm	-	125	ns
11	VOL	Output low level	C_L =50pF, V_{DD} =2V to 3.6V	-	2	MHz
	VOH	Output high level	RLoad=5Kohm	-	125	ns

Table 4-18 IO 引脚输出交流特性

Mode	Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
	f _{max(IO)out}	Maximum frequency		-	2	MHz
$t_{\rm f(IO)out}$	output high to low		_	125		
10		level fall time	$C_L=50pF$, $V_{DD}=2V$ to 3.6V			ns
	t an	output low to high		_	125	
	$t_{r(IO)out}$	level rise time		_	123	
	$f_{\text{max}(\text{IO})\text{out}}$	Maximum frequency		-	10	MHz
	4	output high to low		_	25	
01	$t_{\rm f(IO)out}$	level fall time	$C_L=50pF$, $V_{DD}=2V$ to 3.6V		23	
	t an	output low to high			25	ns
	$t_{r(IO)out}$	level rise time		_	23	
	f _{max(IO)out}	Maximum frequency	C_L =50pF, V_{DD} =2.7V to 3.6V	-	50	MHz
	toro	output high to low	$C_L=50pF, V_{DD}=2.7V \text{ to } 3.6V$	_	5	ns
11	$t_{ m f(IO)out}$	level fall time	CL-30p1, VDD-2.7V to 3.0V	_	,	113
	t ao	output high to low	$C_L=50pF, V_{DD}=2.7V \text{ to } 3.6V$	_	5	ns
	$t_{ m r(IO)out}$	level rise time	CL-30pr, v DD-2.7 v to 3.0 v	_		113

4.2.14 NRST 复位管脚特性

NRST 管脚内部集成了一个上拉电阻,外围应用电路可以不接任何电路,也可以外接 RC 电路。

Table 4-19 NRST 引脚输入特性

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
VIL	NRST 复位低电平	NRST 复位低电平 0.8		V
VIH	NRST 释放	2		V
Vhys	Schmitt trigger 电压		200	mV
Rpull	内部弱上拉		50	K
T _{Noise}	低电平被忽略	100		ns

4.2.15 TIM 计数器特性

Table 4-20 TIM 引脚输入特性

Symbol	Symbol Conditions		Min Max	
Tres(TIM)	Timer resolution time	1	-	T _{TIMxCLK}



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

FEXT	Timer external clock frequency on CH1 to CH4	0	F _{TIMxCLK} /2	MHz
RESTIM	Timer resolution	-	16	bit
Tcounter	16-bit counter clock period when internal clock is selected	1	65536	T _{TIMxCLK}
TMAX_COUNT	Maximum possible count	-	65536x65536	T _{TIMxCLK}

Notes: $f_{TIMxCLK} = 120 \text{ MHz}$

4.2.16 ADC 特性

Table 4-21 ADC 特性

Parameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
F. II 1	SDIF=0	vrefn	-	vrefp	V
Full scale range	SDIF=1	2*(vrefp-vrefn)			V
Input signal common mode		(v:	refp-vrefn)/2	V
Input sample capacitance	-	-	5	-	pF
Input switch equivalent impendence(Rs)	-	-	-	1000	Ohm
Positive reference voltage(vrefp)	-	AVDD	AVDD	AVDD	V
Negative reference voltage(vrefn)	-	0	0	0.1	V
Analog Supply voltage	-	2.0	3.3	5.5	V
Digital Supply voltage	-	1.35	1.5	1.65	V
Current Consumption AVDD	apir 1 0	-	110	-	uA
Current Consumption VDD	SDIF=1,@	-	40	-	uA
Current Consumption vrefp	1Msps	-	35	-	uA
Clock period(t _{clkp})		3333	71.4	23.8	Ns
The high level time of clock(t _{clkh})	-	40%	50%	60%	Telkp
The time delay from rising edge of		0.8		2	***
clock to rising edge of EOC(teocr)	-	0.8	-	3	ns
The time delay from rising edge of	_	0.8	_	3	ns
clock to falling edge of EOC (teocf)	_	0.0	_	3	113
The time delay from rising edge of EOC	_	1.2	_	4	ns
to the data is valid at data bus B(t _{data})					
The setup time of SOC(t _{socs})	-	-	0.7	-	ns
The hold time of SOC(t _{soch})	-	-	0.7	-	ns
The time of Sampling and converting	_	-	14	_	$t_{ m clkp}$
(t _{sp+con})					emp
The time of sample(ts)	-	-	1.5	-	t _{clkp}
THD	-	-	-72	-	db
SNDR	-	-	68	-	db
DNL	-	-1	-	+1	LSB
INL	-	-1.5	-	+1.5	LSB



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

Offset error	-	-16	-	16	LSB

4.2.17 DAC 特性

Table 4-22 DAC 特性

Symbol	Parameter	Min	Тур	Max	Unit
			НК		
V _{DDA}	Analog supply voltage				V
VREF+	Reference supply voltage				V
V _{SSA}	Ground				V
RLOAD	Resistive load with buffer ON				kΩ
RO	Impedance output with buffer OFF				kΩ
C _{LOAD}	Capacitive load				pF
DAC_OUT min	Lower DAC_OUT voltage with buffer ON				V
DAC_OUT max	Higher DAC_OUT voltage with buffer ON				V
DAC_OUT min	Lower DAC_OUT voltage with buffer OFF				mV
DAC_OUT max	Higher DAC_OUT voltage with buffer OFF				V
DDVREF+	DAC DC current consumption in quiescent mode (Standby mode)				μΑ
I _{DDA}	DAC DC current consumption in quiescent mode				μA
					μΑ
DNL	Differential non linearity Difference between two consecutive code-1LSB)				LSB
					LSB
INL	Integral non linearity (difference between measured value at Code i and the value at Code i				LSB
	on a line drawn between Code 0 and last Code 1023)				LSB
Offset	Offset error (difference between measured value at				mV
	Code (0x800) and the ideal value = VREF+/2)				LSB



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

Gain error	Gain error		%
tSETTLING	Settling time (full scale: for a 10-bit input code transition between the lowest and the highest input codes when DAC_OUT reaches final value ±1LSB		μs
Update rate(3)	Max frequency for a correct DAC_OUT change when small variation in the input code (from code i to i+1LSB)		MS/s
tWAKEUP	Wakeup time from off state(Setting the ENx bit in the DAC Control register)		μs
PSRR+	Power supply rejection ratio (to VDDA) (static DC measurement		dB

4.2.18 温度传感器特性

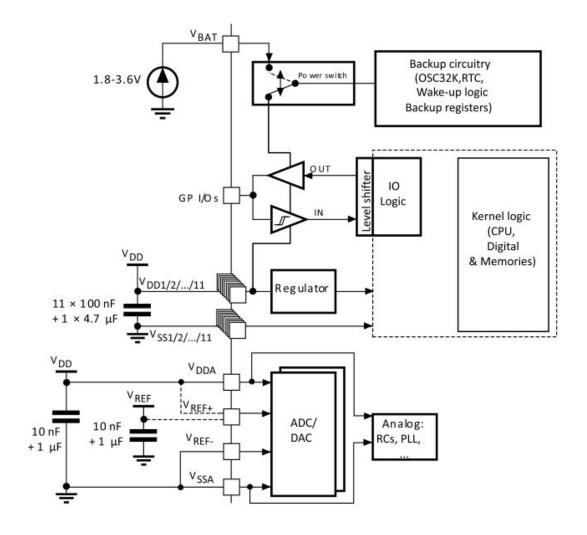
Table 4-23 温度传感器特性

	~	3.51	_		TT
Parameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
Analog Supply voltage	-	2.2	3.3	3.6	V
Digital Supply voltage	-	1.35	1.5	1.65	v
Current Consumption	AVDD	-	150	-	uA
Power down leakage current	en='0'	-	-	1	uA
Power switch control voltage	Power down	-	0	-	V
(Ven)	Power on	-	1	-	Vddl
Sensor linearity with temperature	-	-	±1	±2	$^{\circ}$
Sensor output voltage	at 25℃	1.34	1.43	1.52	V
Sensor Gain	-	4.0	4.3	4.6	mV/℃
Output load capacitor	-	-	-	20	Pf
Output current	-	-40	-	+40	uA
Power up time(t _{START})	-	4	-	10	us

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

5 典型电路

5.1 电源供电



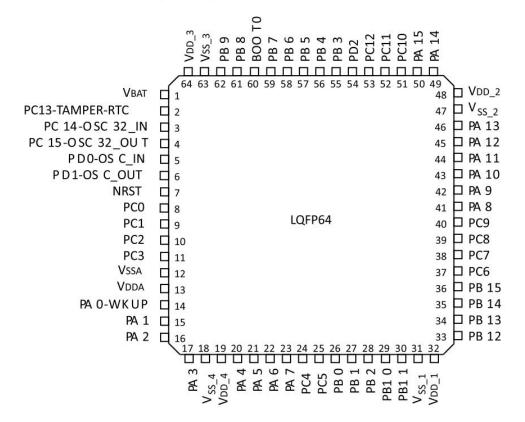
5.2 其他参考电路

TBD

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

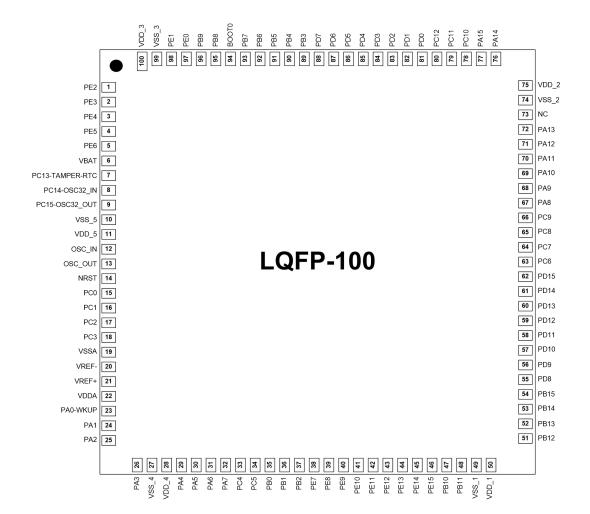
6 管脚定义

HK32F39A 定义了 LQFP64/LQFP100 两种封装,管脚定义如下。





Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.





Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

64	100	Pin Name	Туре	Level	Main function	Alternate functions	
LQFP64	LQFP100				Tunction	Default	Remap
	1	PE2	I/O	-	PE2	TRACECKO/FSMC_A23 ADC2_BGRBUF	TXEV/EXTIN2
	2	PE3	I/O	-	PE3	TRACED0/FSMC_A19 ADC2_AIN18	TXEV/EXTIN3
	3	PE4	I/O	-	PE4	TRACED1/FSMC_A20 ADC3_BGRBUF	TXEV/EXTIN4
	4	PE5	I/O	-	PE5	TRACED2/FSMC_A21 ADC3_AIN18	TXEV/EXTIN5
	5	PE6	I/O	-	PE6	TRACED3/FSMC_A22	TXEV/EXTIN6
1	6	VBAT	S	-	VBAT		



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

2	7	PC13-TAM PER-RTC	I/O Note3	-	PC13	TAMPER-RTC/WKUP1/RTCO QSPI_BK1_NCS	TXEV/EXTIN13
3	8	PC14-OSC 32_IN	I/O Note3	-	PC14	OSC32_IN/LSE_CKI	TXEV/EXTIN14
4	9	PC15-OSC 32_OUT	I/O Note3	-	PC15	OSC32_OUT	TXEV/EXTIN15
	10	VSS_5	S	-	VSS_5		
	11	VDD_5	S	-	VDD_5		
5	12	OSC_IN	I	-	OSC_I N	OSC_IN/HSE_CKI CAN1_RX ²	TXEV/PD0 ² EXTIN0 ²
6	13	OSC_OUT	0	-	OSC_O UT	OSC_OUT CAN1_TX ²	TXEV/PD1 ² EXTIN1 ²



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

7	14	NRST	I/O	-	NRST		
8	15	PC0	I/O	-	PC0	ADC123_IN10 DCMI_PIXCLK	TXEV/EXTIN0 FSMC_A13
9	16	PC1	I/O	-	PC1	ADC123_IN11 DCMI_PIXDI13/TFT_RST1	TXEV/EXTIN1
10	17	PC2	I/O	-	PC2	ADC123_IN12 DCMI_PIXDI12/TFT_VSYNC1	TXEV/EXTIN2
11	18	PC3	I/O	-	PC3	ADC123_IN13 DCMI_PIXDI11/TFT_HSYNC1	TXEV/EXTIN3
12	19	VSSA	S	-	VSSA		
	20	VREF-	S	-	VREF-		



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

	21	VREF+	S	-	VREF+		
13	22	VDDA	S	-	VDDA		
14	23	PA0-WKUP	I/O Note3	-	PA0	WKUP0/USART2_CTS/ADC123_IN0 TIM2_CH1_ETR/TIM5_CH1/TIM8_ETR/EXTIN0 DCMI_PIXDI10/	TXEV FSMC_NE4
15	24	PA1	I/O	-	PA1	USART2_RTS/ADC123_IN1 TIM5_CH2/TIM2_CH2/EXTIN1 RCC_CKI0/DCMI_PIXDI9	TXEV FSMC_A14
16	25	PA2	I/O	-	PA2	USART2_TX/TIM5_CH3 ADC123_IN2/TIM2_CH3/EXTIN2 TFT_DCLK	TXEV
17	26	PA3	I/O	-	PA3	USART2_RX/TIM5_CH4 ADC123_IN3/TIM2_CH4/EXTIN3 DCMI_PIXDI8/	TXEV FSMC_A15



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

18	27	VSS_4	S	-	VSS_4		
19	28	VDD_4	S	-	VDD_4		
20	29	PA4	I/O	-	PA4	SPI1_NSS/USART2_CK DAC_OUT1/ADC12_IN4/EXTIN4 TFT_RST2/I2S1_WS/TIM5_ETR	TXEV
21	30	PA5	I/O	-	PA5	SPI1_SCK/DAC_OUT2 ADC12_IN5/EXTIN5 TFT_VSYNC2/I2S1_CK	TXEV
22	31	PA6	I/O	-	PA6	SPI1_MISO/TIM8_BKIN ADC12_IN6/TIM3_CH1/EXTIN6 TFT_HSYNC2	TXEV/TIM1_BKIN
23	32	PA7	I/O	-	PA7	SPI1_MOSI/TIM8_CH1N/ADC12_IN7/TIM3_CH2/EXTIN7 DCMI_PIXDI7/I2S1_SD	TXEV/TIM1_CH1N FSMC_A0



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

24	33	PC4	I/O	-	PC4	ADC12_IN14 DCMI_PIXDI6//I2S1_MCK	TXEV/EXTIN4 FSMC_A1
25	34	PC5	I/O	-	PC5	ADC12_IN15 DCMI_PIXDI5	TXEV/EXTIN5 FSMC_A2
26	35	PB0	I/O Note3	-	PB0	ADC12_IN8/TIM3_CH3/TIM8_CH2N WKUP2/DCMI_PIXDI4	TXEV/TIM1_CH2N/EXTIN0 FSMC_A3/CAN2_RX
27	36	PB1	I/O	-	PB1	ADC12_IN9/TIM3_CH4/TIM8_CH3N RCC_CKI1/DCMI_PIXDI3	TXEV/TIM1_CH3N/EXTIN1 FSMC_A4/CAN2_TX
28	37	PB2	I/O	-	PB2	BOOT1 QSPI_BK1_IO0/USART6_CK	TXEV/EXTIN2 FSMC_A5
	38	PE7	I/O		PE7	FSMC_D4	TXEV/TIM1_ETR/EXTIN7
	39	PE8	I/O		PE8	FSMC_D5	TXEV/TIM1_CH1N/EXTIN8



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

40	PE9	I/O	PE9	FSMC_D6	TXEV/TIM1_CH1/EXTIN9
41	PE10	I/O	PE10	FSMC_D7	TXEV/TIM1_CH2N/EXTIN10
42	PE11	I/O	PE11	FSMC_D8	TXEV/TIM1_CH2/EXTIN11
43	PE12	I/O	PE12	FSMC_D9	TXEV/TIM1_CH3N/EXTIN12
44	PE13	I/O	PE13	FSMC_D10	TXEV/TIM1_CH3/EXTIN13
45	PE14	I/O	PE14	FSMC_D11	TXEV/TIM1_CH4/EXTIN14
46	PE15	I/O	PE15	FSMC_D12	TXEV/TIM1_BKIN/EXTIN15



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

29	47	PB10	I/O	PB10	I2C2_SCL/USART3_TX VC1_O	TXEV/TIM2_CH3/EXTIN10 FSMC_INT2/
30	48	PB11	I/O	PB11	I2C2_SDA/USART3_RX VC2_O	TXEV/TIM2_CH4/EXTIN11 FSMC_INT3
31	49	VSS_1	S	VSS_1		
32	50	VDD_1	S	VDD_1		
33	51	PB12	I/O	PB12	SPI2_NSS/I2S2_WS/I2C2_SMBA/USART3_CK/TIM1_BKIN DCMI_PIXDI2/TFT_RST3/ADC3_VOLTDIV/CAN2_RX	TXEV/EXTIN12
34	52	PB13	I/O	PB13	SPI2_SCK/I2S2_CK/USART3_CTS/TIM1_CH1N DCMI_PIXDI1/TFT_VSYNC3/CAN2_TX/USART6_TX	TXEV/EXTIN13
35	53	PB14	I/O	PB14	SPI2_MISO/TIM1_CH2N/USART3_RTS DCMI_PIXDI0/TFT_HSYNC3/USART6_RX	TXEV/EXTIN14



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

36	54	PB15	I/O	PB15	SPI2_MOSI/I2S2_SD/TIM1_CH3N USART4_CK	TXEV/EXTIN15 FSMC_INTR
	55	PD8	I/O	PD8	FSMC_D13	TXEV/USART3_TX/EXTIN8
	56	PD9	I/O	PD9	FSMC_D14	TXEV/USART3_RX/EXTIN9
	57	PD10	I/O	PD10	FSMC_D15	TXEV/USART3_CK/EXTIN10
	58	PD11	I/O	PD11	FSMC_A16_CLE	TXEV/USART3_CTS/EXTIN11
	59	PD12	I/O	PD12	FSMC_A17_ALE	TXEV/TIM4_CH1/USART3_RT S/EXTIN12
	60	PD13	I/O	PD13	FSMC_A18	TXEV/TIM4_CH2/EXTIN13



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

	61	PD14	I/O	PD14	FSMC_D0	TXEV/TIM4_CH3/EXTIN14
	62	PD15	I/O	PD15	FSMC_D1	TXEV/TIM4_CH4/EXTIN15
37	63	PC6	I/O	PC6	I2S2_MCK/TIM8_CH1/SDIO_D6 USART4_CTS	TXEV/TIM3_CH1/EXTIN6 FSMC_A6
38	64	PC7	I/O	PC7	I2S3_MCK/TIM8_CH2/SDIO_D7 RCC_CKI2/USART4_RTS	TXEV/TIM3_CH2/EXTIN7 FSMC_A7
39	65	PC8	I/O	PC8	TIM8_CH3/SDIO_D0	TXEV/TIM3_CH3/EXTIN8 FSMC_A8/USART1_CTS/USA RT5_TX
40	66	PC9	I/O	PC9	TIM8_CH4/SDIO_D1	TXEV/TIM3_CH4/EXTIN9 FSMC_A9/USART1_RTS/USA RT5_RX
41	67	PA8	I/O	PA8	USART1_CK/TIM1_CH1/MCO/EXTIN8 QSPI_BK1_IO1	TXEV FSMC_A10



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

42	68	PA9	I/O	PA9	USART1_TX/TIM1_CH2/EXTIN9 QSPI_BK1_IO2	TXEV FSMC_A11
43	69	PA10	I/O	PA10	USART1_RX/TIM1_CH3/EXTIN10 QSPI_BK1_IO3	TXEV FSMC_A12
44	70	PA11	I/O	PA11	USART1_CTS/USBDM/CAN1_RX/TIM1_CH4/EXTIN11 DCMI_VSYNC	TXEV
45	71	PA12	I/O	PA12	USART1_RTS/USBDP/CAN1_TX/TIM1_ETR/EXTIN12 DCMI_HSYNC	TXEV
46	72	PA13	I/O	JTMS-S WDIO	USART6_CTS	PA13 TXEV/DCMI_VSYNC FSMC_NIORD
	73	NC				
47	74	VSS_2	S	VSS_2		



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

48	75	VDD_2	S	VDD_2		
49	76	PA14	I/O	JTCK-S WCLK	EXTIN14 DCMI_HSYNC/FSMC_A14/ /USART5_CK	PA14 TXEV/FSMC_NIOWR USART2_CTS/I2C1_SMBA
50	77	PA15	I/O	JTDI	SPI3_NSS/I2S3_WS/EXTIN15 QSPI_CKO/USART6_RTS/I2S1_WS	TXEV/TIM2_CH1_ETR/PA15/S PI1_NSS FSMC_NREG/USART2_RTS
51	78	PC10	I/O	PC10	USART4_TX/SDIO_D2 VC1_N	TXEV/USART3_TX/EXTIN10 FSMC_A24/USART2_TX
52	79	PC11	I/O	PC11	USART4_RX/SDIO_D3 VC1_P	TXEV/USART3_RX/EXTIN11 FSMC_A25/USART2_RX
53	80	PC12	I/O	PC12	USART5_TX/SDIO_CK VC2_N	TXEV/USART3_CK/EXTIN12 FSMC_NE2_NCE3/USART2_ CK



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

	81	PD0 ^{Note4}	I/O	PD0	FSMC_D2	TXEV/CAN1_RX/EXTIN0
	82	PD1 Note4	I/O	PD1	FSMC_D3	TXEV/CAN1_TX/EXTIN1
54	83	PD2	I/O	PD2	TIM3_ETR/USART5_RX/SDIO_CMD VC2_P	TXEV/EXTIN2 FSMC_NE3_NCE4_1
	84	PD3	I/O	PD3	FSMC_CLK USART5_CTS	TXEV/USART2_CTS/EXTIN3 SPI3_NSS/I2S3_WS
	85	PD4	I/O	PD4	FSMC_NOE USART5_RTS	TXEV/USART2_RTS/EXTIN4 SPI3_SCK/I2S3_CK
	86	PD5	I/O	PD5	FSMC_NWE	TXEV/USART2_TX/EXTIN5 SPI3_MISO
	87	PD6	I/O	PD6	FSMC_NWAIT	TXEV/USART2_RX/EXTIN6 SPI3_MOSI/I2S3_SD



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

	88	PD7	I/O	PD7	FSMC_NE1/FSMC_NCE2	TXEV/USART2_CK/EXTIN7
55	89	PB3	I/O	JTDO	SPI3_SCK/I2S3_CK TFT_RST4/QSPI_BK2_NCS/ADC3_IN5/VC3_N	TXEV/PB3/TRACESWO/TIM2_ CH2/SPI1_SCK/EXTIN3 DCMI_PIXDI13/I2S1_CK
56	90	PB4	I/O	NJTRS T	SPI3_MISO TFT_VSYNC4/QSPI_BK2_IO0/ADC3_IN6/VC3_P	TXEV/PB4/TIM3_CH1/SPI1_M ISO/EXTIN4 DCMI_PIXDI12
57	91	PB5	I/O	PB5	I2C1_SMBA/SPI3_MOSI/I2S3_SD TFT_VSYNC4/QSPI_BK2_IO1/ADC3_IN7/VC4_N	TXEV/TIM3_CH2/SPI1_MOSI/ EXTIN5 DCMI_PIXDI11/CAN2_RX/I2S 1_SD
58	92	PB6	I/O	PB6	I2C1_SCL/TIM4_CH1 QSPI_BK2_IO2/ADC3_IN8/VC4_P	TXEV/USART1_TX/EXTIN6 DCMI_PIXDI10/FSMC_NCE4_ 2/CAN2_TX/I2S1_MCK
59	93	PB7	I/O	PB7	I2C1_SDA/FSMC_NADV/TIM4_CH2 RCC_CKI3/QSPI_BK2_IO3	TXEV/USART1_RX/EXTIN7



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

60	94	воото	I	воото		
61	95	PB8	I/O	PB8	TIM4_CH3/SDIO_D4 VC3_O	TXEV/I2C1_SCL/CAN1_RX/E XTIN8 FSMC_CD/USART4_TX
62	96	PB9	I/O	PB9	TIM4_CH4/SDIO_D5 VC4_O	TXEV/I2C1_SDA/CAN1_TX/E XTIN9 USART4_RX
	97	PE0	I/O	PE0	TIM4_ETR/FSMC_NBL0	TXEV/EXTIN0
	98	PE1	I/O	PE1	FSMC_NBL1	TXEV/EXTIN1
63	99	VSS_3	S	VSS_3		
64	10 0	VDD_3	S	VDD_3		



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

Notes:

- 1. I = input, O=output, I/O= input/output, S= power supply
- 2. 参考 7.1 节
- 3. 除了这些 IO,都具有 Schmitt 功能,可通过寄存器配置
- 4. 参考 7.1 节

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

7 功能说明

7.1 OSC_IN/OSC_OUT 复用功能说明

LQFP64 Pin5/6: 上	电默认是 OSC	_IN/OS	C_OUT 功能,可以转	次件 remap 配置为 PD0/PD1 功能,也可以配置为其他 AF 功能				
Pin5	OSC_IN	Ю	OSC_IN	OSC_IN/HSE_CKI CAN1_RX	TXEV/PD0 EXTIN0			
Pin6	OSC_OUT	Ю	OSC_OUT	OSC_OUT CAN1_TX	TXEV/PD1 EXTIN1			
	LQFP100 Pin12/Pin13: 上电默认是 OSC_IN/OSC_OUT 功能,可以软件配置为 HSECKI 功能 Pin81/Pin82: 上电默认是 PD0/PD1,可以配置为其他 AF 功能							
Pin12	OSC_IN	I	OSC_IN	OSC_IN/HSE_CKI	-			

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

Pin13	OSC_OUT	0	OSC_OUT	OSC_OUT	-

7.2 FSMC 复用功能说明

TBD

7.3 TFT 复用功能说明

TBD

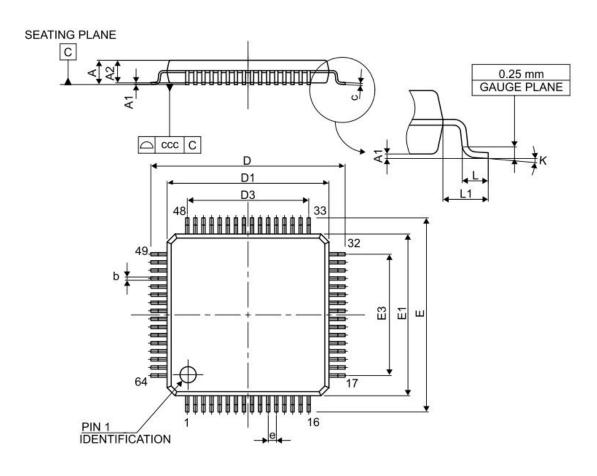
7.4 USART 复用功能说明

TBD

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

8 封装参数

8.1 LQFP64 10X10mm,0.5mm pitch



C		millimeters		inches ⁽¹⁾			
Symbol	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	
Α	-) -)	1.600	-	-	0.0630	
A1	0.050	626	0.150	0.0020	-	0.0059	
A2	1.350	1.400	1.450	0.0531	0.0551	0.0571	
b	0.170	0.220	0.270	0.0067	0.0087	0.0106	
С	0.090	:-:	0.200	0.0035	-	0.0079	
D	~	12.000	-	949	0.4724	% = 0	
D1	24 50	10.000	8	-	0.3937	-	
D3	-	7.500		-	0.2953	25	
E	-	12.000	-	-	0.4724	11-1	
E1	4	10.000	2	-	0.3937	×=:	

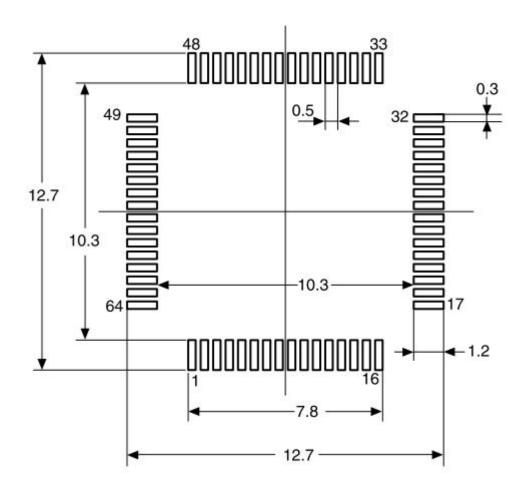


Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

0		millimeters		inches ⁽¹⁾			
Symbol	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	
E3	15.0	7.500	-	-	0.2953	-	
е		0.500	-	-	0.0197	-	
К	0°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°	
L	0.450	0.600	0.750	0.0177	0.0236	0.0295	
L1		1.000		-	0.0394	-	
ccc	-	-	0.080	-	-	0.0031	

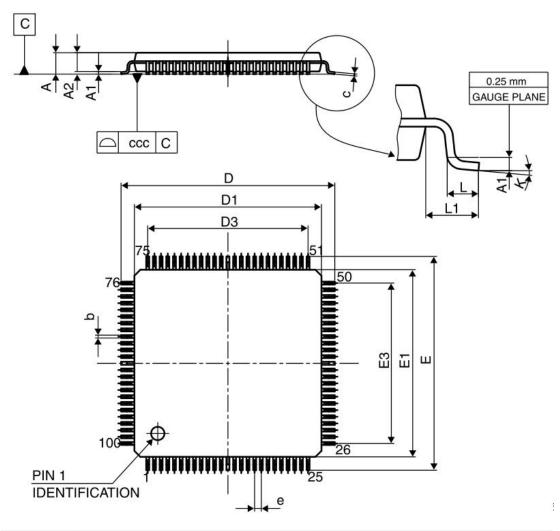
^{1.} Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.

8.2 LQFP64 推荐封装



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

8.3 LQFP100 14X14mm,0.5mm pitch



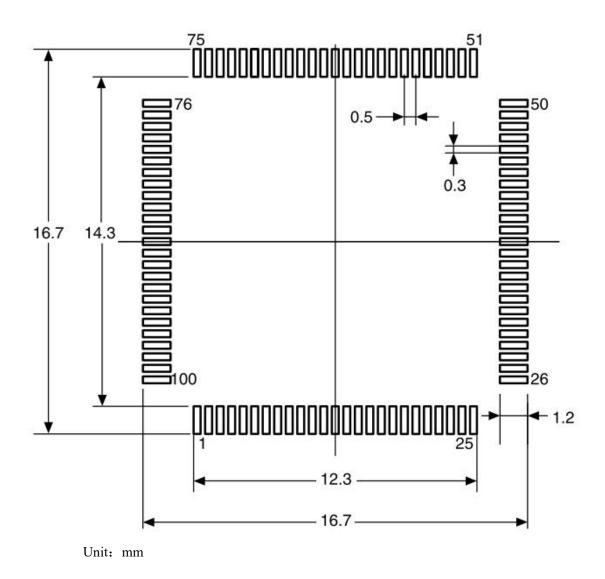
Symbol	millimeters			inches ⁽¹⁾		
	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max
Α	37=0	, -)	1.600	-	-	0.0630
A1	0.050	-	0.150	0.0020		0.0059
A2	1.350	1.400	1.450	0.0531	0.0551	0.0571
b	0.170	0.220	0.270	0.0067	0.0087	0.0106
С	0.090	-	0.200	0.0035	=	0.0079
D	15.800	16.000	16.200	0.6220	0.6299	0.6378
D1	13.800	14.000	14.200	0.5433	0.5512	0.5591
D3	-	12.000	-	128	0.4724	-
E	15.800	16.000	16.200	0.6220	0.6299	0.6378
E1	13.800	14.000	14.200	0.5433	0.5512	0.5591



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

Symbol -	millimeters			inches ⁽¹⁾		
	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max
E3	-	12.000	-	-	0.4724	-
е	-	0.500	-	-	0.0197	-
L	0.450	0.600	0.750	0.0177	0.0236	0.0295
L1	6 0	1.000	-	-	0.0394	-
k	0°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°
ccc	(5)	=	0.08		-	0.0031

8.4 LQFP100 推荐封装





Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

9 缩略语

Term	Definition			
RTC	Real time clock			
IIC	Inter-Integrated Circuit Interface			
CPU	Center process unit			
PLL	Phase lock loop			
LDO	Low voltage drop output			
RISC	Reduced Instruction-Set Computer			
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter			
SPI	Serial peripheral interface			
USB	Universal Serial Bus			
GPIO	General purpose input output			
CAN	Controller Area Network			
I/O	Input output			
ADC	Analogue to digital converter			
MCU	Micro controller unit			
HSE	High-speed external			
HSI	High-speed internal			
LSE	Low-speed external			
LSI	Low-speed internal			
SAR	Successive Approximation Analog-to-Digital Converter			
USART	Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter			
PVD	Power voltage detect			
SOC	System on chip			
JTAG	Joint Test Action Group			
PWM	Pulse Width Modulation			
DMA	Direct Memory Access			
SDIO	Secure Digital Input Output			
POR	Power on reset			
PDR	Power down reset			
CRC	Cyclic Redundancy Check			



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co.,Ltd.

10 重要提示

在未经深圳市航顺芯片技术研发有限公司同意下不得以任何形式或途径修改本公司产品规格和数据表中的任何部分以及子部份。深圳市航顺芯片技术研发有限公司在以下方面保留权利: 修改数据单和/或产品、停产任一产品或者终止服务不做通知;建议顾客获取最新版本的相关信息,在下定订单前进行核实以确保信息的及时性和完整性。所有的产品都依据订单确认时所提供的销售合同条款出售,条款内容包括保修范围、知识产权和责任范围。

深圳市航顺芯片技术研发有限公司保证在销售期间,产品的性能按照本公司的标准保修。公司认为有必要维持此项保修,会使用测试和其他质量控制技术。除了政府强制规定外,其他仪器的测量表没有必要进行特殊测试。

顾客认可本公司的产品的设计、生产的目的不涉及与生命保障相关或者用于其他危险的活动 或者环境的其他系统或产品中。出现故障的产品会导致人身伤亡、财产或环境的损伤(统称高危 活动)。人为在高危活动中使用本公司产品,本公司据此不作保修,并且不对顾客或者第三方负 有责任。

深圳市航顺芯片技术研发有限公司将会提供与现在一样的技术支持、帮助、建议和信息,(全部包括关于购买的电路板或其他应用程序的设计,开发或调试)。特此声明,对于所有的技术支持、可销性或针对特定用途,及在支持技术无误下,电路板和其他应用程序可以操作或运行的,本公司将不作任何有关此类支持技术的担保,并对您在使用这项支持服务不负任何法律责任。

所有版权归深圳市航顺芯片技术研发有限公司 2015 - 2020